

A40i硬件设计指南

CONTENTS



01 24M晶振

02 AUDIO CODEC

03 CSI

04 EMMC

05 NAND

06 ETHERNET

07 HDMI

08 RGB/LVDS/DSI

CONTENTS



09 SATA

10 SDIO

11 TS

12 TVIN

13 TVOUT/CVBS/VGA

14 USB

15 WIFI/BT

16 GPS

CONTENTS



17 THERMAL

18 ESD

19 PMU

20 DRAM

21 KEY

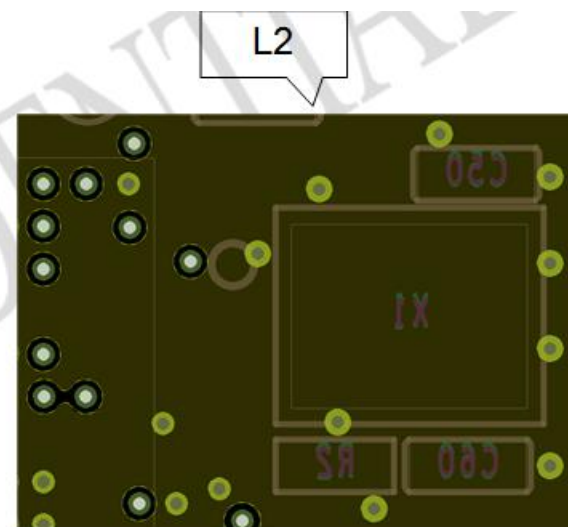
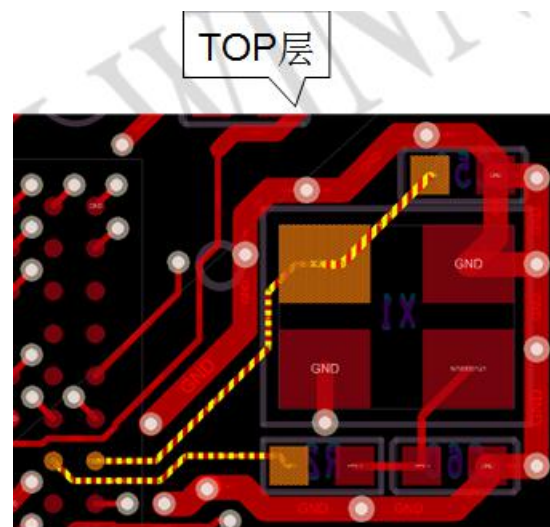
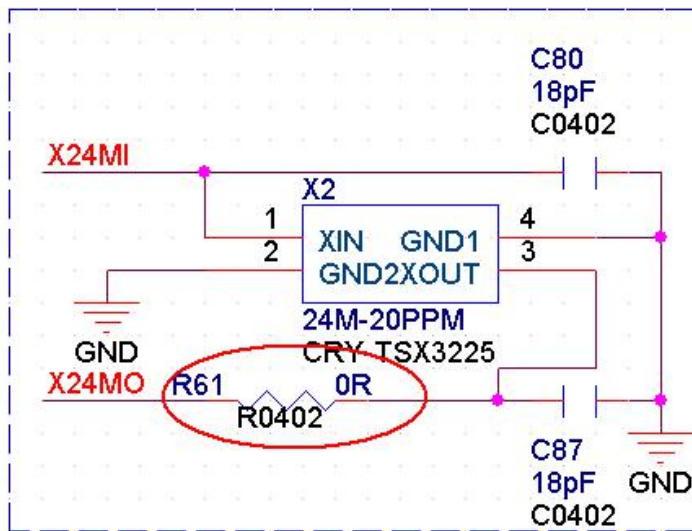
22 STACK UP

23 SOC FANOUT

24 REVISION HISTORY

01 24M晶振

1.高频晶振的网络X24MO上串接电阻必须保留，方便调试时钟信号幅度，晶振选型20 ppm/无源晶振。



- 2.晶体尽量靠近IC摆放，避免晶体走线过长。
- 3.晶振的匹配电容必须靠近晶振摆放
- 4.晶体及其走线区域的外围和相邻层，用GND屏蔽保护。
- 5.晶体及其走线区域的相邻层，禁止其它走线。

02 AUDIO CODEC



1. AVCC、VRP、VRA1、VRA2和AGND接地电容、电阻依次靠近主控摆放。
2. AVCC走线 ≥ 25 mil ; VRP、VRA1、VRA2线宽 ≥ 10 mil ; 线长 ≤ 300 mil。远离高速干扰信号。
3. AGND需有一片覆铜。覆铜宽度 ≥ 80 mil , AGND接地电阻连接到GND平面的过孔 ≥ 2 个。
4. AVCC VRA1 VRA2 VRP、HPCOMFEB接地电容、电阻连接到AGND覆铜。
5. VCC-HP、HPBP电容靠近芯片放置。走线需大于10mil。
6. GND-HP从芯片出来直接连接GND。
7. HPOUTL、HPCOM、HPCOMFEB、HPOUTR并行走线并包地 , HPOUTL、HPOUTR在两旁 , HPCOM、HPCOMFEB在中间 , 整组包地。线宽10 mil。走线及过孔远离高速信号及时钟信号。

02 AUDIO CODEC



8. MIC 摆放位置靠近电路板的边沿，远离 ($\geq 200\text{mil}$) RF、PA、开关电源。
9. ESD 器件必须靠近MIC摆放，从MIC引出来的走线必须先经过ESD器件，在连接其他器件。
10. MICxP、MICxN，类差分走线，线宽4mil，线距4mil，包地。
11. LINEINL、LINEINR、FIMINL、FMINR每对L、R信号分别包地，线宽4mil。走线及过孔远离高速信号及时钟信号。
12. PHONEOUTP、PHONEOUTN、HPOUTL、HPOUTR每对P、N信号分别类差分走线，线宽4mil，线距4mil，包地。
13. 当外部使用功放IC时,外部功放仿真板子的PCB板的边沿,电源走线宽度 $\geq 15\text{mil}$, 输入输出信号线线宽10mil，并包地。

02 AUDIO CODEC

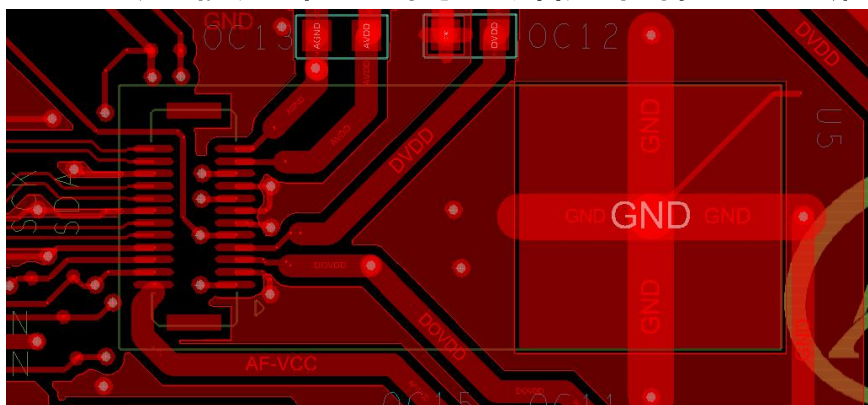


14.耳机接法必须考虑实际采用的耳机座子与信号的连接关系，并考虑采用欧标或者美标四段式耳机。

15.HPOUTL HPOUTR如果做耦合的方式输出需要把HPCOMFB HPCOM这两个脚拉一个对地1uF电容。

03 CSI

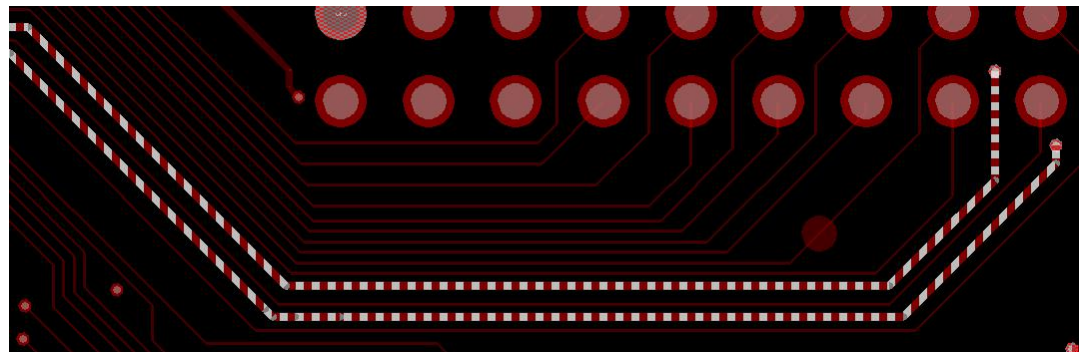
1. CSI模组走线线宽15~20mil
2. 为保证Sensor 模组接地良好，模组散热焊盘尽可能通过多个点与大片GND连接。
3. PCB对应模组位置需紧贴大面积的金属，以便散热。如下图所示：



4. PCLK的对地电容靠近主控，串联电阻靠近模组；
5. MCLK的对地电容靠近模组，串联电阻靠近主控；

03 CSI

6. Hsync的对地电容靠近主控；
7. Vsync、Hsync、Data串联电阻靠近模组；
8. 为了避免模组端的电容、电阻、排阻等器件被其他元器件遮挡，影响调试，建议统一放置在背面；
9. 保证模组的摄像头开孔位置，与摄像头插座位置的距离尽量近，防止摄像头模组FPC过长出现问题；
10. 电源滤波电容靠近模组放置；
11. MCLK和PCLK需要各自包地，如下图所示；如果PCB空间有限，不能保证信号线完整包地时，需保持该信号线在间距 $\geq 15\text{mil}$ 空间内无其他走线；



03 CSI



- 12. 连线时保证较少的换层（MCLK、PCLK换层过孔 ≤ 2 个）。
- 13. PCLK和Data走线长度尽量一致，允许相差不超过500mil，尽量不要因为追求等长而走蛇形线等等。
- 14. 走线间距大于2倍线宽。
- 15. PCLK和MCLK上必须增加NC电容或者0R电阻用于提高摄像头的兼容性以及降低时钟信号的EMI辐射。
- 16. AVDD-CSI与IOVDD-CSI必须单独供电，以保证AVCC-CSI的稳定性。
- 17. 若模组带自动对焦功能，由于给内部VCM的供电的AF-VCC电源噪声较大，注意不要与其他敏感电源（如AVDD）共用。

03 CSI



18. 摄像头模组PIN脚定义：检查摄像头模组的PIN定义，是否与插座一致。特别需要注意一般24PIN插座有上接触或下接触可选择，检查模组金手指接触面的方向。

19. 如果前后摄像头上电时序完全不同时，必须分开AVDD和IOVDD

04 EMMC



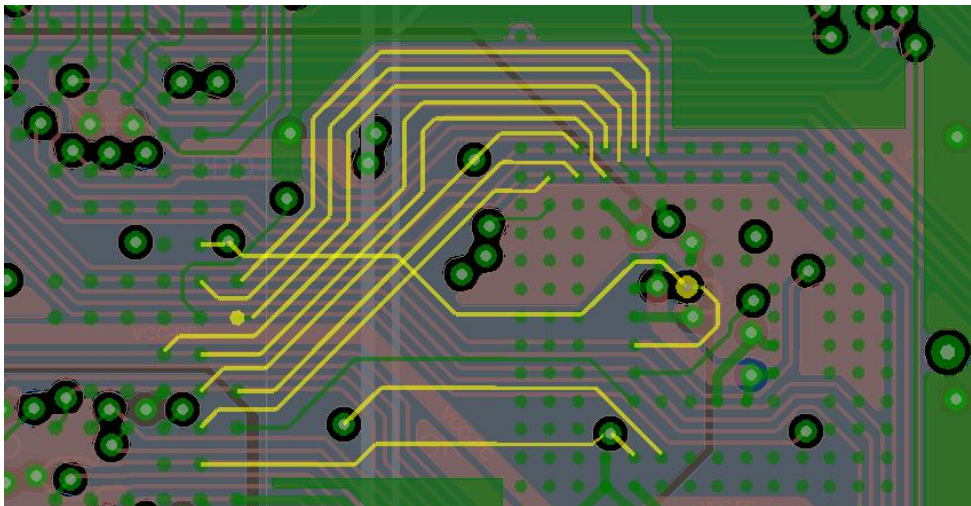
1. DS信号在HS400模式下是读操作的时钟信号，因此走线的要求与CLK信号基本相同。
2. eMMC靠近主控摆放。如果主控对应GPIO使用独立电源供电（通常为VCC-PC），则将去耦电容靠近主控端供电输入引脚摆放
3. VCCQ, VCC, VDDi的所有去耦电容均靠近eMMC摆放。
4. CLK信号串接电阻靠近主控摆放，串阻与主控CLK连接走线距离 $\leq 300\text{mil}$ 。

04 EMMC

5. 信号线走线要求：

- (1) eMMC与主控间走线长度 $\leq 2000\text{mil}$ ；
- (2) 走线阻抗50欧；
- (3) 线间距 ≥ 2 倍线宽；
- (4) D0~D7、DS相对CLK等长控制 $\leq 300\text{mil}$ ；
- (5) D0~D7上使用过孔的数量尽量相同。

6. 除Reset外，务必保证所有信号走线参考平面完整，示意图如下：



04 EMMC



7. VCC,VCCQ线宽不小于12mil，或直接使用敷铜代替电源走线。电源线上如有过孔，则过孔数量不少于2个，避免过孔限流影响供电。
8. CLK和DS信号做包地处理，包地通过过孔与GND平面连接。如果不能包地则保持线间距 ≥ 3 倍线宽。
9. 走线尽量避开高频信号。
10. eMMC NC/RFU等保留引脚都悬空，不可为了走线方便将这些信号与电源、地、或其他eMMC信号连接在一起。如果确实走线有困难，可适当修改eMMC PCB封装，去掉一些NC/RFU的ball。
11. 如果期望eMMC运行在较高频率，则建议只使用eMMC，保证主控IO与eMMC点对点连接。如果NAND/eMMC双Layout时，走线采用菊花链方式，将eMMC作为走线的终点，尽量减少分叉线长度(标案中U52和U50 双layout叠放，放置于菊花链最末端，U51放置于SOC和EMMC的中间位置)

05 NAND



1. RE、WE、DQS本质上是一个时钟信号线，用于数据采样
2. NAND应靠近主控摆放。
3. 如果主控对应GPIO使用独立电源供电（通常为VCC-PC），则将去耦电容靠近主控端供电输入引脚摆放。
4. VCCQ, VCC的所有去耦电容均靠近NAND摆放。
5. RE、WE、DQS信号串接电阻靠近主控摆放，串阻与主控连接走线距离 $\leq 300\text{mil}$ 。

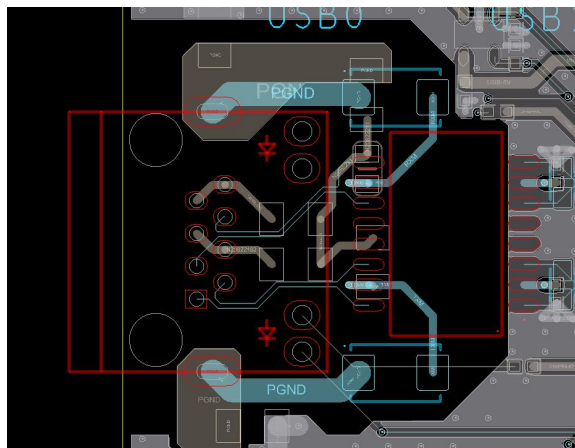
05 NAND



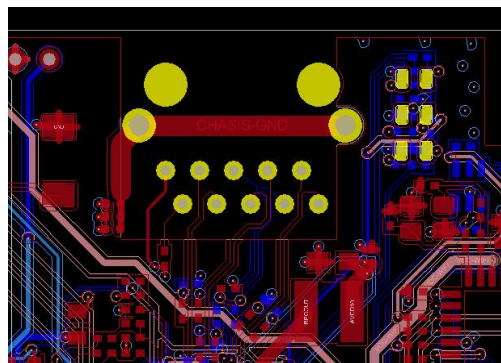
- 6. NAND与主控走线间走线 $\leq 2000\text{mil}$ ，信号走线阻抗50欧，信号线间距 ≥ 2 倍线宽；
- 7. D0~D7、RE、WE相对于DQS做等长，控制 $\leq 300\text{mil}$ ，使用过孔的数量尽量相同，务必保证走线参考平面完整。
- 8. VCC,VCCQ线宽不小于12mil。
- 9. 建议对RE、WE、DQS信号做包地处理，包地线通过过孔与GND平面连接。
- 10. 走线尽量避开高频信号。
- 11. VPS0和VPS1的电路连接需要参照相应NAND的DATASHEET作处理，具体连接可参考标案

06 ETHERNET

1. 变压器靠近RJ45座子摆放。

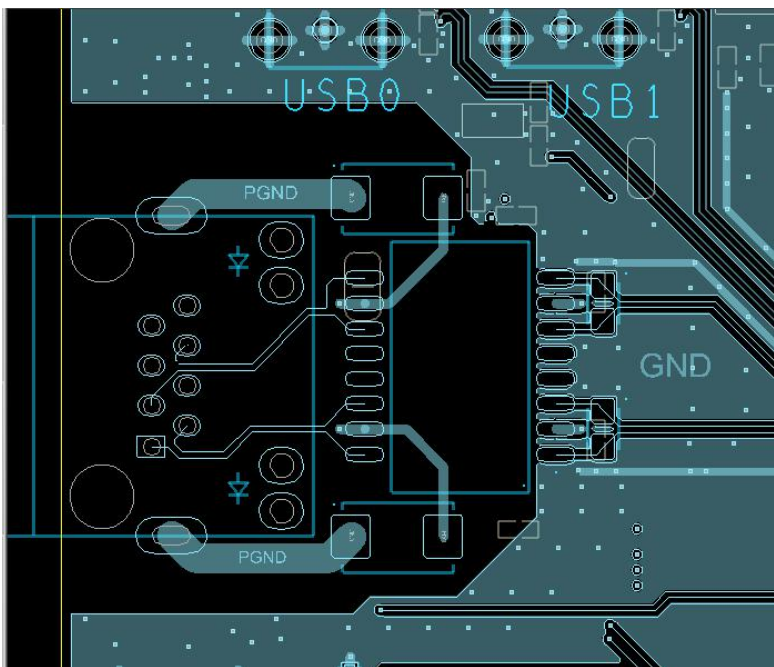


2. 以太网LED灯靠近座子摆放。



06 ETHERNET

3. RJ45及变压器下面所有层不铺铜，掏空。

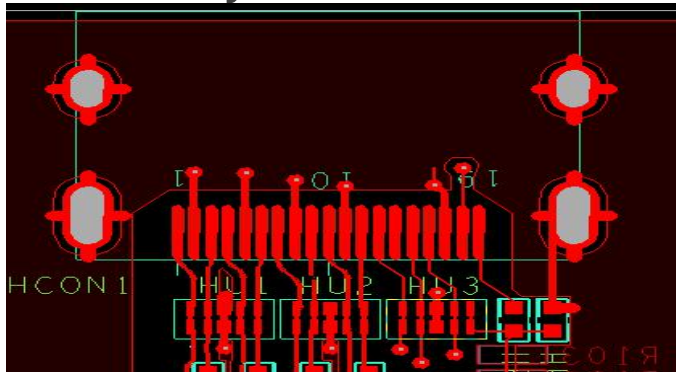


4. 外挂100M和1000M PHY 差分对布线

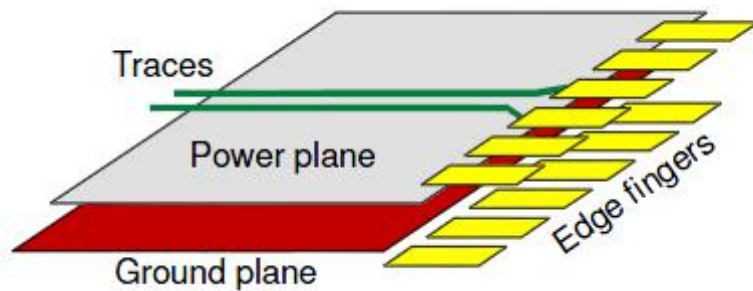
- (1) 需要完整参考平面
- (2) 差分阻抗100 ohms $\pm 10\%$
- (3) 对内等长误差<20mil
- (4) 对间等长误差<200mil

07 HDMI

1. PCB Layout时ESD器件靠近HDMI插座，见下图



2. HDMI座子以及信号走线的路径上，避免出现其他任何走线或电源板块，参考做法如下图：



07 HDMI



3. HDMI的差分信号线做等长差分线走线，差分线包地，差分阻抗要求 $100\ \text{ohms} \pm 10\%$

4. HDMI差分推荐线宽和线距

$W=5.5\text{mil}$; $C=9\text{mil}$, (推荐)

$W=4.5\text{mil}$; $C=8\text{mil}$, (基本)

实际方案中，使用此推荐值可能无法做到 100ohm 差分阻抗。此时应该在差分阻抗偏差不超出 $\pm 10\%$ 的基础上，尽量去保证线宽。

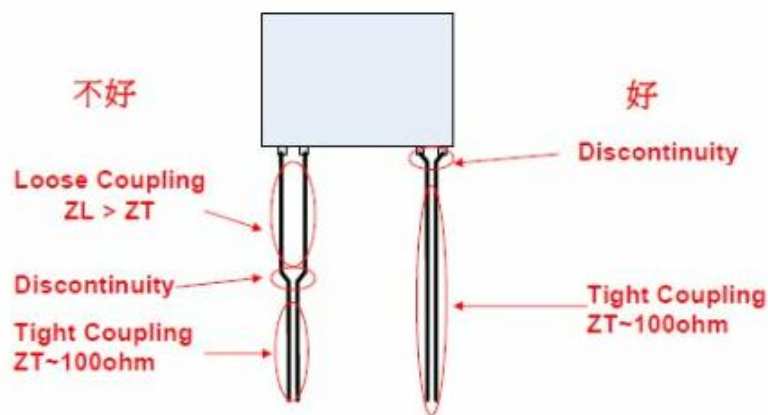
5. 差分对间保证 $3W$ 以上的间距；

6. HDMI信号线长度 $< 3000\text{mil}$ ，差分线应该尽量顺直的从HDMI座子并行走走到主控，不要刻意为了追求等长走“蛇形线”，需要保证HDMI差分线对内等长误差 $< 200\text{mil}$ ，对间等长误差 $< 1000\text{mil}$ ；

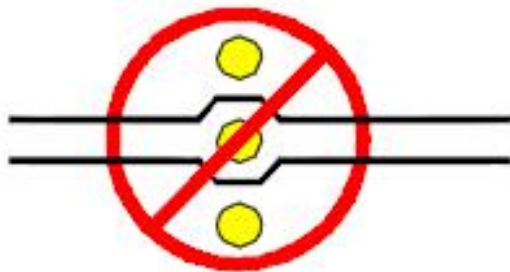
7. 差分走线过孔不超过2个，最好不打过孔。

07 HDMI

8. 尽量避免阻抗不连续，不要有90度转角的走线方式：90度转角的地方线宽较宽，阻抗会降下来，因此会产生不连续点；45度转角产生的不连续比较小，在可接受的范围内



9. HDMI差分线走线范围内最好不要有破坏差分走线的过孔，如下图



08 RGB/LVDS/DSI



1. 尽量满足3W原则，如不能，则至少要满足2W原则
2. CLK要做包地处理，同时要注意对包地打孔；
3. LCD线的参考平面要完整（尽量满足）；
4. VCC-PD的104滤波电容注意要尽量靠近IC端放置；
5. 如果LCD线有多功能复用，如LVDS功能，RGB功能加其他功能，尽量采用菊花链拓扑，减少分叉。
6. LVDS差分走线要求：
 - 1080P：差分对内长度差10mil内，差分对之间的长度差180mil内。
 - 720P：差分对内长度差20mil内，差分对之间的长度差450mil内。
 - 阻抗要求：单端50欧姆，差分100欧姆。

08 RGB/LVDS/DSI



7. DSI差分走线要求：

- (1) 阻抗要求：单端50欧姆，差分100欧姆。
- (2) 差分约束：差分对内长度差10mil内，差分对之间的长度差160mil内。
- (3) 尽量保证走线的参考平面完整。
- (4) VCC-DSI处的104电容注意要尽量靠近IC端摆放

09 SATA



1. VDD25-SATA走线线宽8~12mil ;
2. VDD25-SATA以及VDD12-SATA的去耦电容和滤波电容 , 需要靠近IC摆放 ;
3. SATA信号线TXP, TXM, RXP, RXM的串入电容 , 必须靠近connetor摆放 ;
4. SATA信号线TXP, TXM, RXP, RXM , 建议在表层走线 , 保证走线相邻层必须有连续完整的参考平面 , 并且参考面没有被分割 ;
5. TXP, TXM, RXP, RXM始终保证差分并排走线 , 差分阻抗为100欧 , 走线不能分叉 ; 拐角的角度需保证大于135度 ; 保证信号走线的长度控制在4000mil以内 , 走线的过孔不超过2个 ;
6. 建议优先考虑TXP, TXM, RXP, RXM走线 , 并与其它信号的间距大于10 mil , 且避免走线走在器件的下面或者与其他信号交叉。

10 SDIO



1. CLK串接电阻靠近主控摆放。串阻与主控CLK连接走线距离 $\leq 300\text{mil}$ 。
2. ESD器件靠近Device（卡座或Wifi模组）摆放。
3. VDD网络上的电阻和电容网络靠近Devcie（卡座或Wifi模组）摆放。
4. 卡座背面禁止放置插装器件，防止插装器件管脚干涉卡插拔。
5. 信号线走线要求：
 - （1）走线阻抗50欧；
 - （2）线间距不小于2倍线宽；
 - （3）D0~D3相对CLK等长控制 $< 500\text{mil}$ ；

10 SDIO



6. 信号线走线参考平面完整；
7. CLK做包地处理，包地通过过孔与GND平面连接。如果不能包地则保持线间距 ≥ 3 倍线宽。
8. VDD走线宽度不小于12mil；
9. 卡座管脚走线先与ESD器件相连后，再连其它器件；
10. 走线尽量避开高频信号。

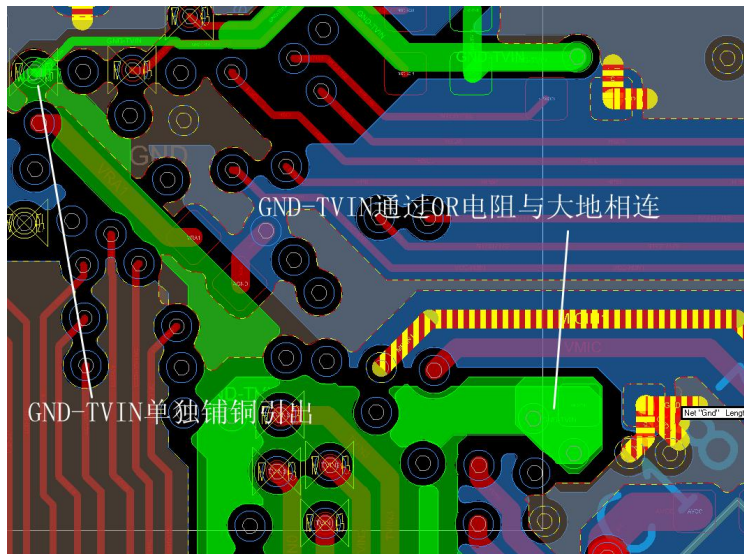
11 TS



1. 走线间距尽量满足3W原则。
2. 尽量保证走线的参考平面完整。

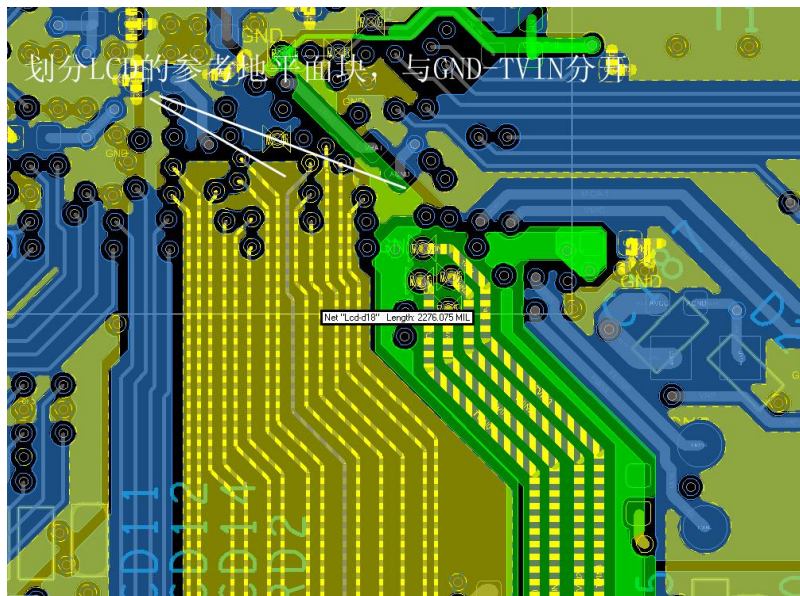
12 TVIN

1. 去耦电容靠近电源PIN放置，距离PIN距离不超过200mil。
2. VCC-TVIN走线及其过孔远离高速信号，远离高速信号的过孔。尤其是并行LCD信号。
3. VCC-TVIN走线线宽不少于20mil。
4. GND-TVIN从IC端引出单独分配一片覆铜，铜宽不小于50mil。通过0R电阻与系统GND平面连接。



12 TVIN

5. GND-TVIN的回流路径注意要避开LCD信号的GND回流路径。



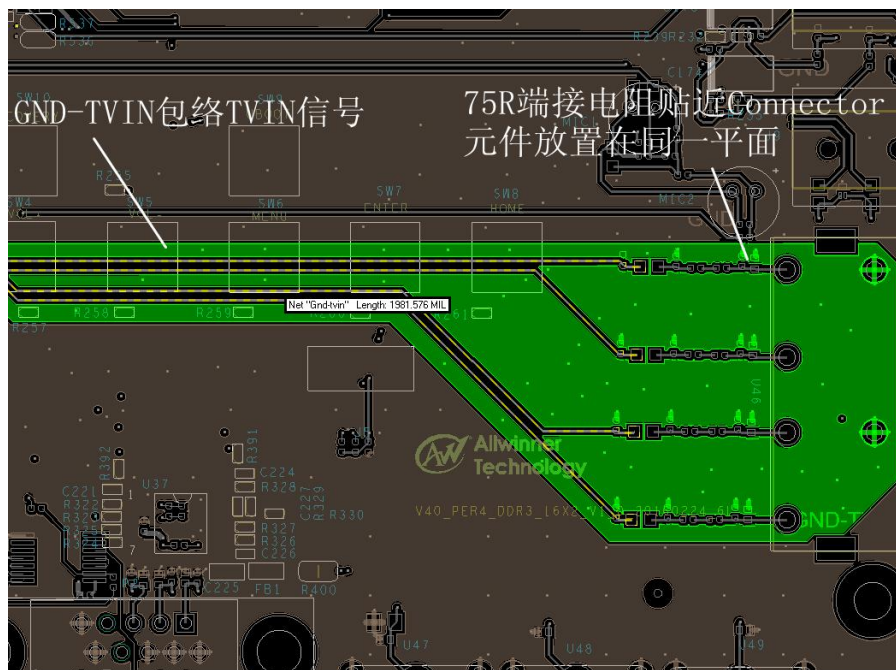
6. VRP-TVIN, VRN-TVIN去耦电容靠近PIN的位置放置，距离PIN距离不超过200mil，走线不小于10mil。

7. 走线及过孔远离高速信号，远离高速信号的过孔。尤其是并行LCD信号。

8. VRP-TVIN、VRN-TVIN采用差分走线。

12 TVIN

9. 走线及过孔远离高速信号，远离高速信号的过孔，尤其是并行LCD信号。
10. 75R端接电阻贴近Connector放置。信号通道上的元件放置在同一走线层。
11. TVIN信号线采用37.5ohm阻抗匹配，采用GND-TVIN包络。

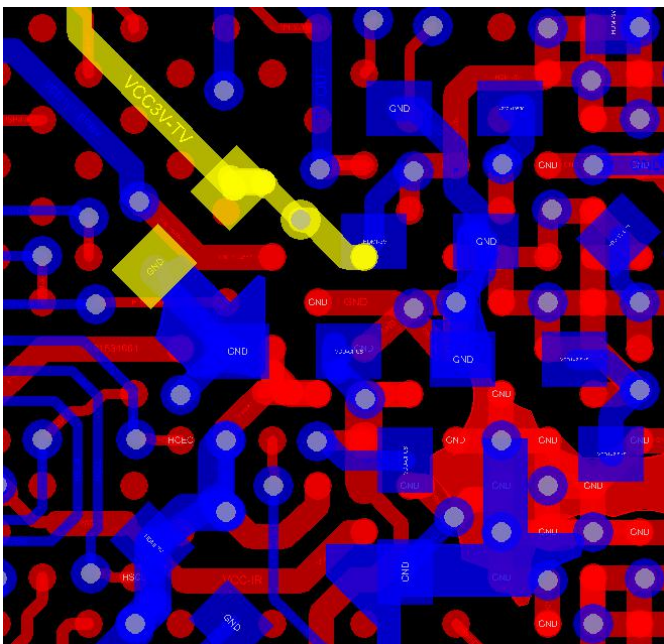


13 TVOUT/CVBS/VGA

1.每路TVOUT需要电流为45mA，可根据方案TVOUT输出确定VCC-TVOUT线宽

	1路TVOUT方案	4路TVOUT方案
VCC-TVOUT线宽	20mil	40mil

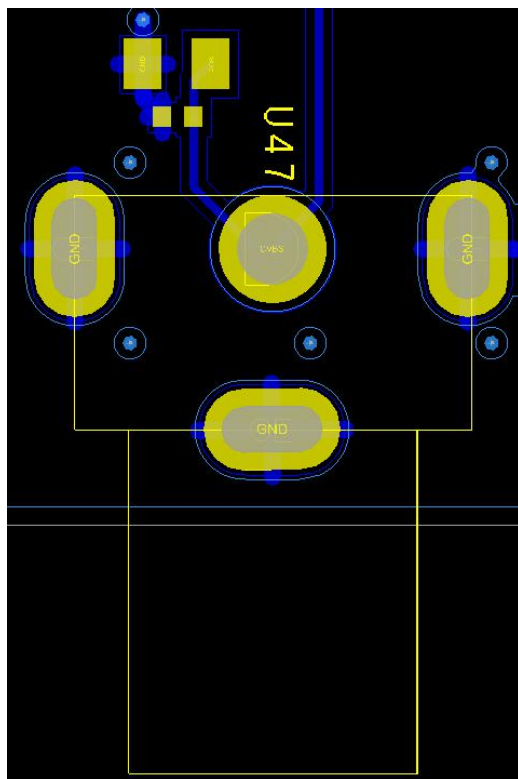
2. VCC-TVOUT电容最好放置在主控PIN正下方，距离PIN距离不超过200mil



13 TVOUT/CVBS/VGA

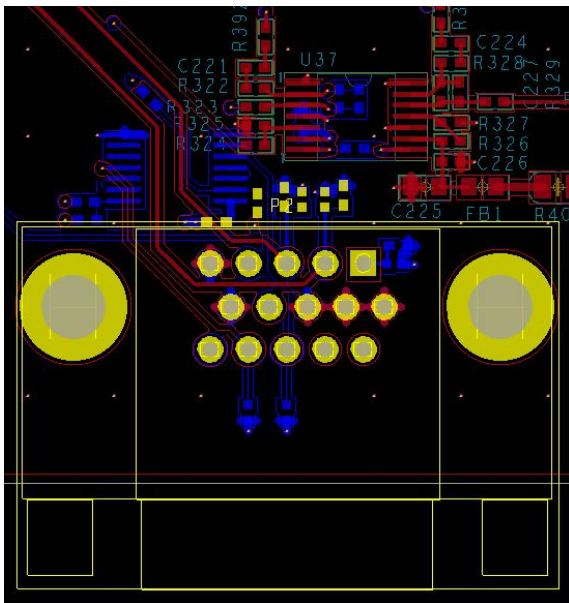
3. 75ohm终端电阻和ESD器件以及滤波电阻电容靠近座子摆放，如下

(1) 1路TVOUT CVBS方案



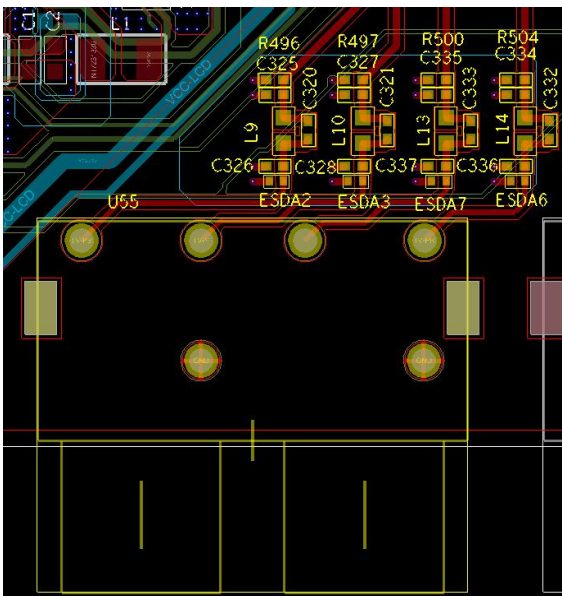
13 TVOUT/CVBS/VGA

(2) 3路TVOUT VGA方案



13 TVOUT/CVBS/VGA

(3) 4路TVOUT YPbPr+CVBS方案

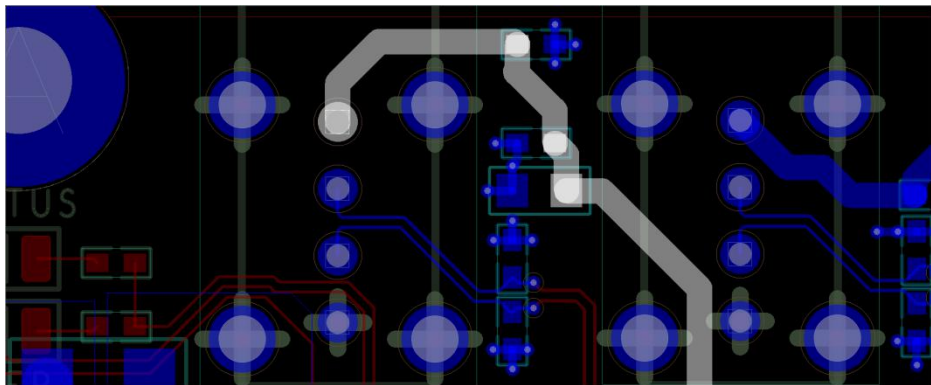


4. TVOUT信号线需要参考完整地平面对

5. TVOUT信号线采用37.5ohm阻抗匹配

14 USB

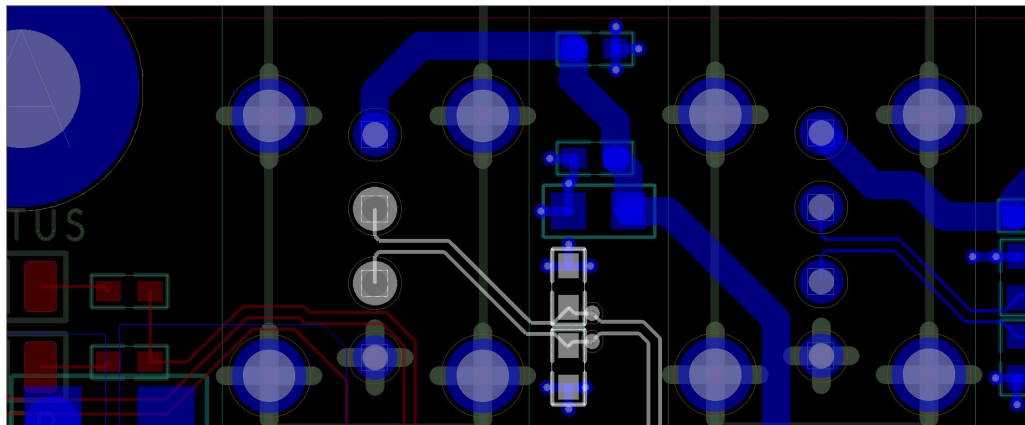
1. VCC3V3-USB走线线宽8~12mil ;
2. USB-5V电压到USB SOCKET的 VBUS PIN的回路，电流最高可达1A，线宽需要控制在40mil以上，
见图



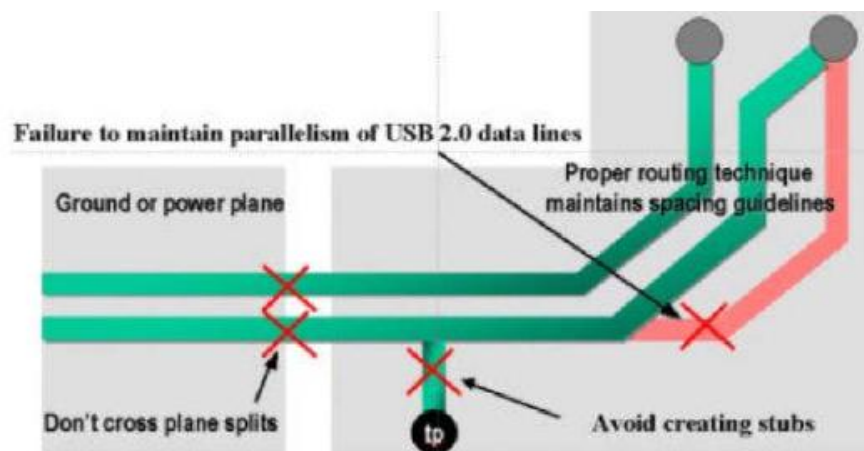
3. VCC3V3-USB的去耦电容和滤波电容，需要靠近IC摆放；
4. USB SOCKET的去耦电容，应靠近SOCKET的VBUS PIN摆放；

14 USB

5.为了获得较好的ESD防护能力，TVS器件需要靠近USB 座子摆放，见图



6. USB信号线DM、DP，建议在表层走线，保证走线相邻层必须有连续完整的参考平面，并且参考面没有被分割；



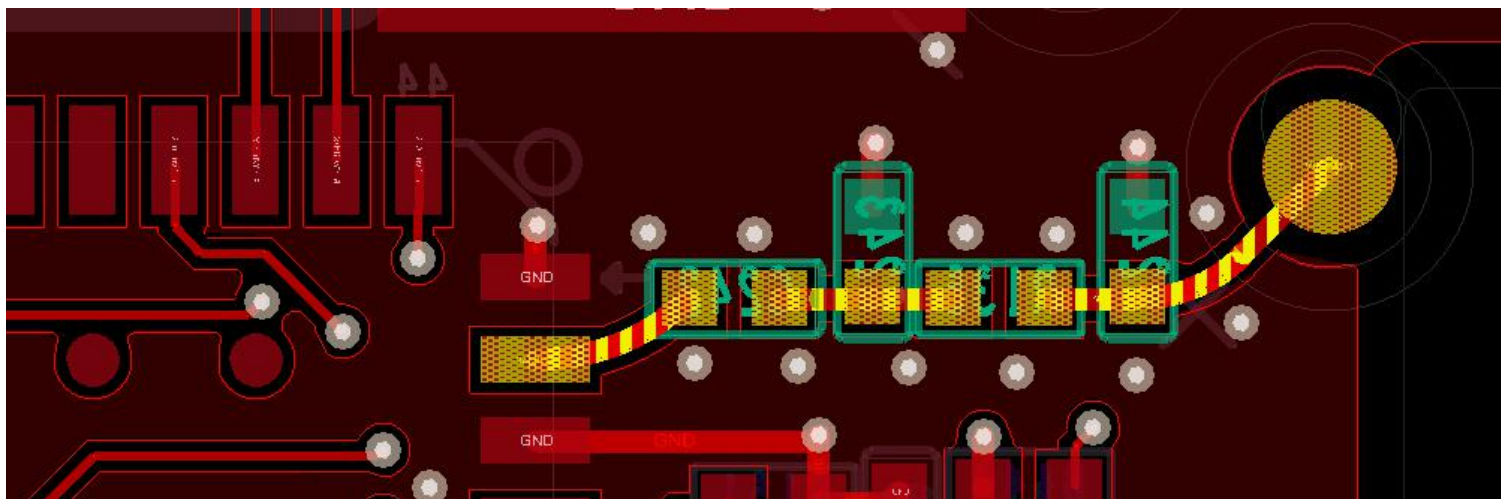
14 USB



7. DM、DP始终保证差分并排走线，差分阻抗为90欧，走线不能分叉；拐角的角度需保证大于135度；保证USB走线的长度控制在4000mil以内，走线的过孔不超过2个；
8. 建议优先考虑DM、DP走线，并与其它信号的间距大于10 mil，且避免走线走在器件的下面或者与其他信号交叉。
9. DM、DP为高速信号线，并接的TVS要求低容值，否则影响数据传输，以小于或等于4pF为宜。
10. DM、DP连线与USB SOCKET要一一对应，不要反接。

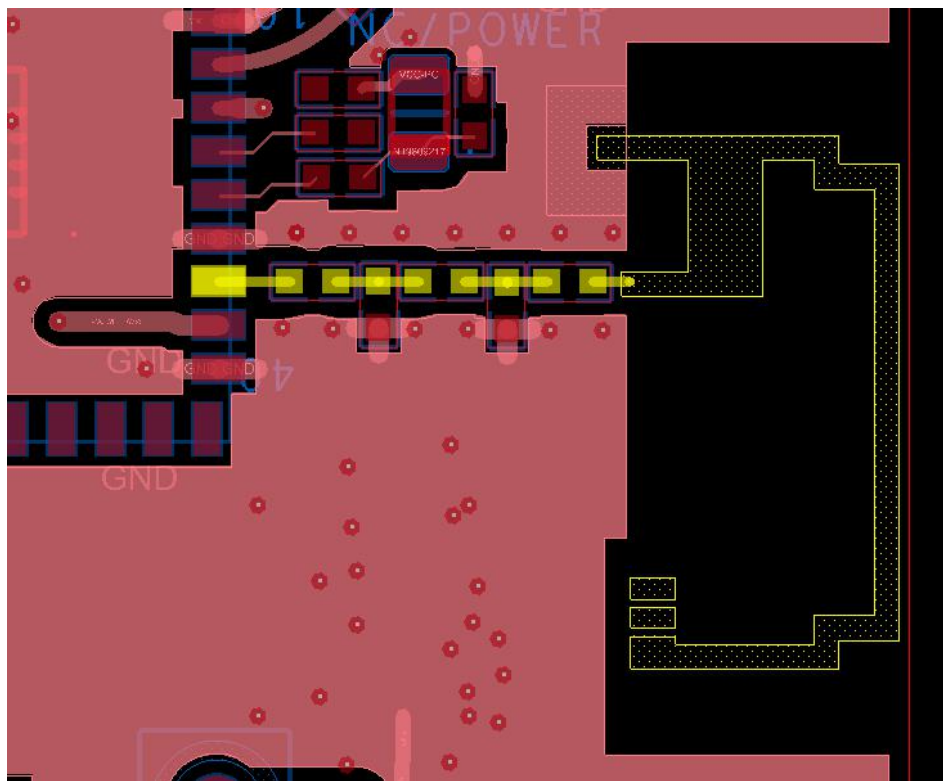
15 WIFI/BT

1. 模组尽量靠近天线或天线接口。远离电源、DDR、LCD电路、摄像头、马达、SPEAKER等易产生干扰的模块
2. 天线馈线控制50ohm，左右包地并沿途多打GND过孔。为了增大线宽减少损耗，通常馈线相邻层挖空，第3层需要完整参考地。
3. 合理布局天线馈线的匹配电容电阻，使馈线平滑，最短。无分支，无过孔，少拐角。



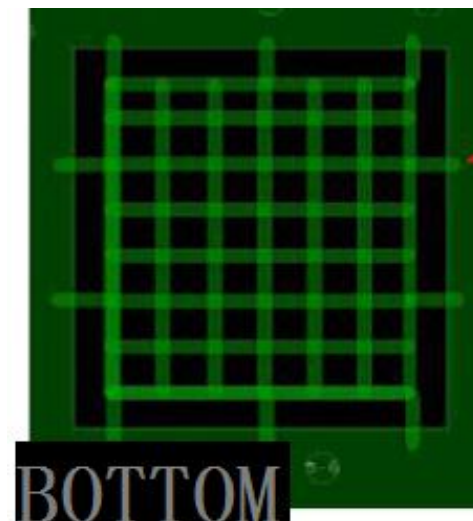
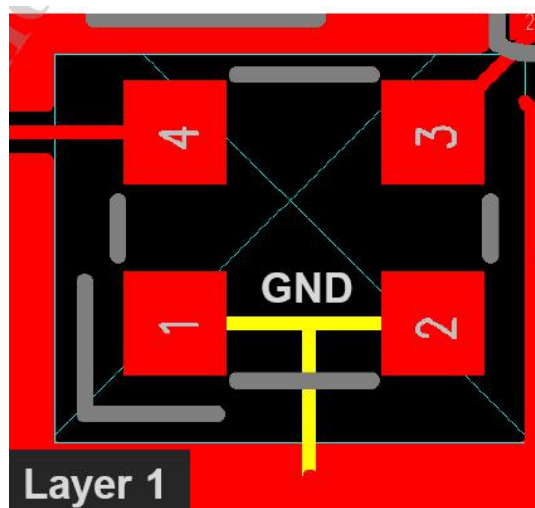
15 WIFI/BT

4. 如使用PCB走线作天线，请确保天线走线附近区域完全净空，净空区大于50mm²。天线本体至少距周围的金属1cm以上。



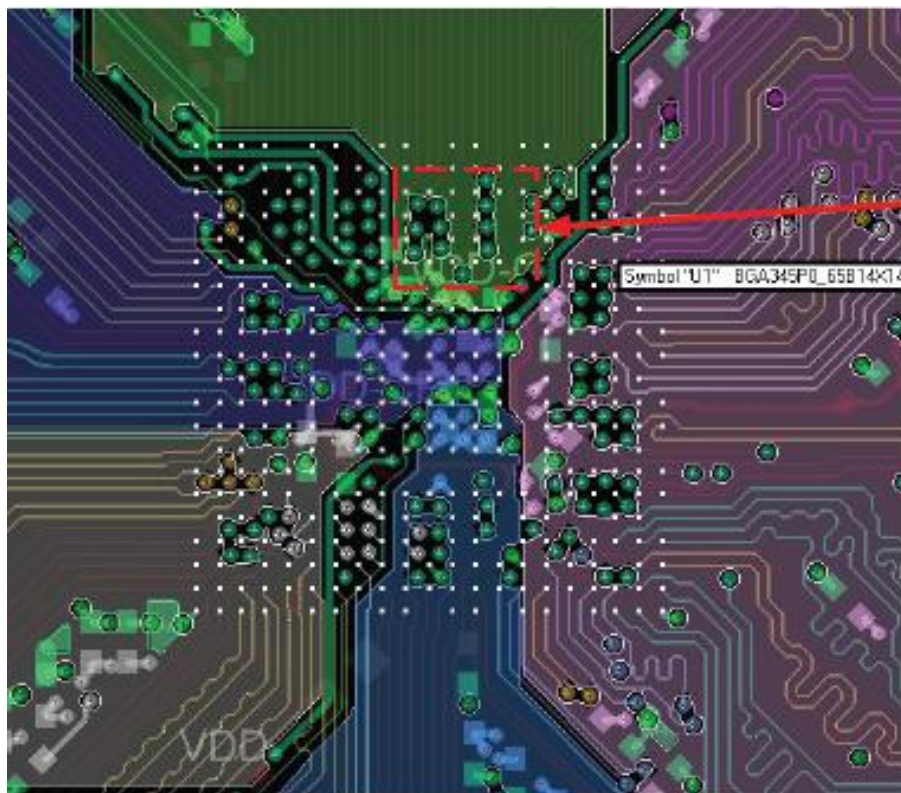
16 GPS

1. GPS电路位置，远离电源、DDR、LCD电路、摄像头、马达、SPEAKER等易产生干扰的模块，间距至少20mm。
2. TCXO对温度敏感，尽量远离PMU、CPU、PA、散热器等发热体。TCXO靠近GPS BB摆放。
3. 为减少温度影响，TCXO下方各层都必须净空（Bottom层除外），Bottom层以“网格形状”覆地，并且“网格形状”入地点要少一些。
4. TCXO接地管脚单点入地

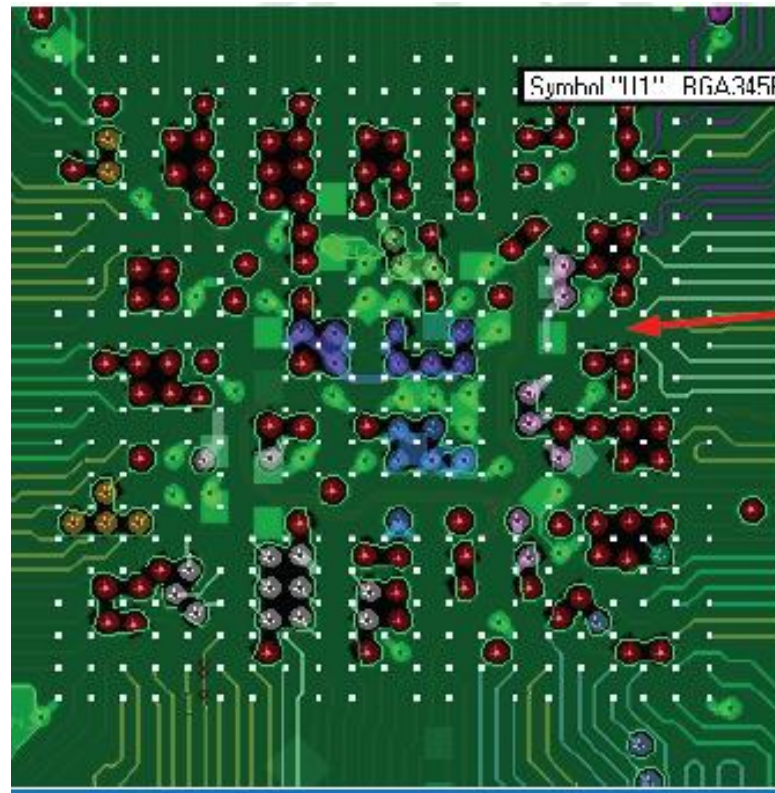


17 THERMAL

1.保证GND平面和电源层各电源部分平面的完整性，以保证热量的平摊



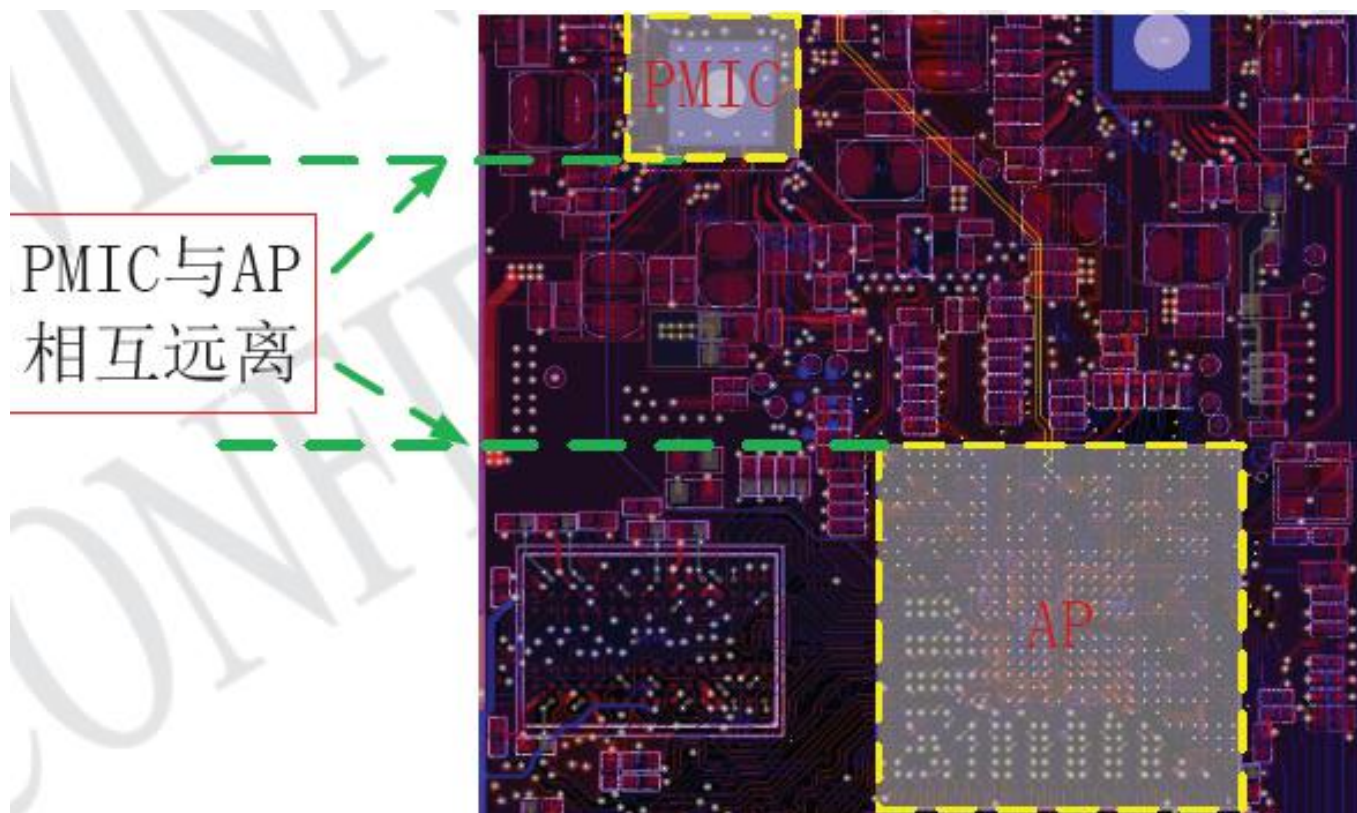
保证电源
层平面完
整性



保证GND
层平面
完整性

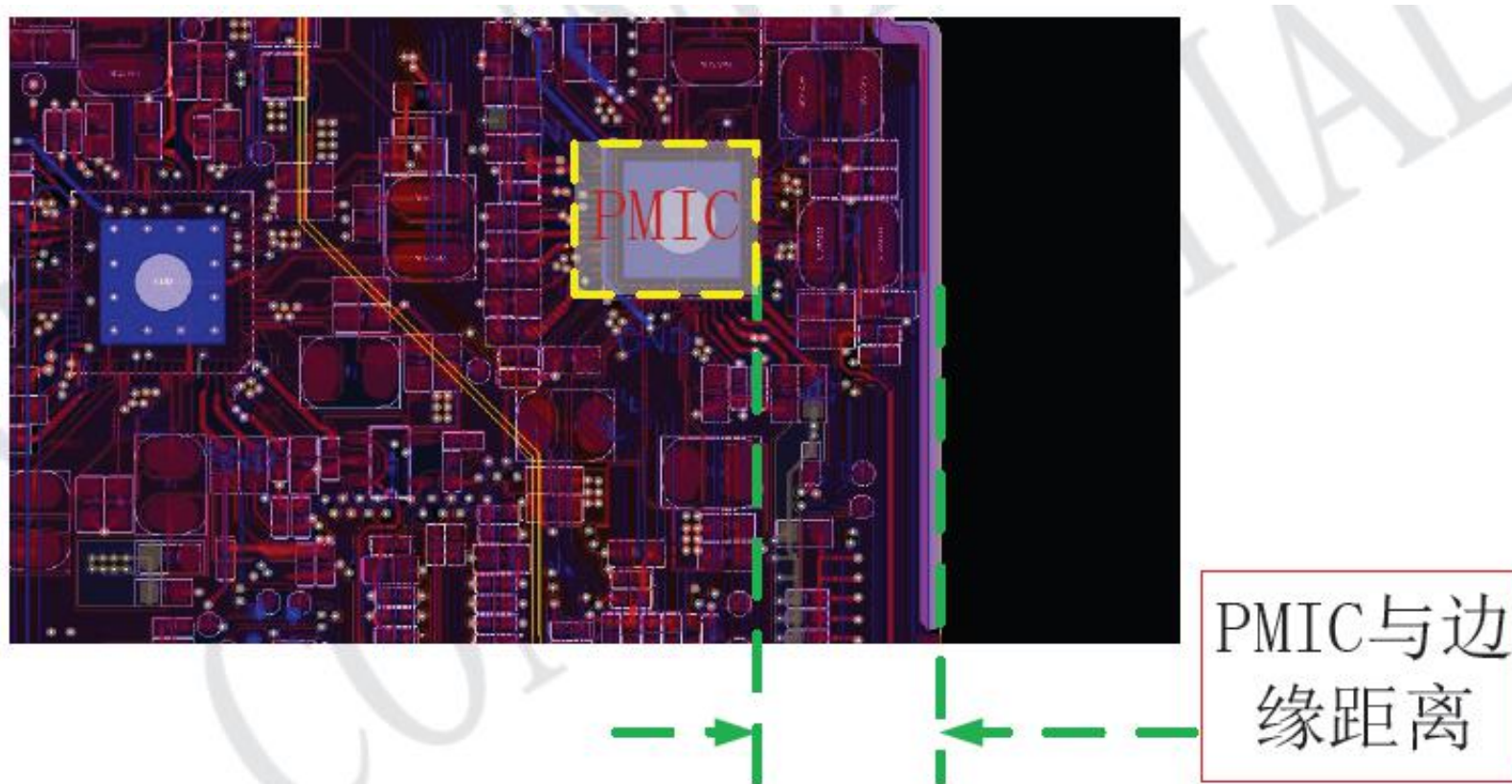
17 THERMAL

2. PCB板上较大功率器件均匀摆放，避免多个热源靠在一起；AP与PMIC/Modem/PA的距离不小于20mm。



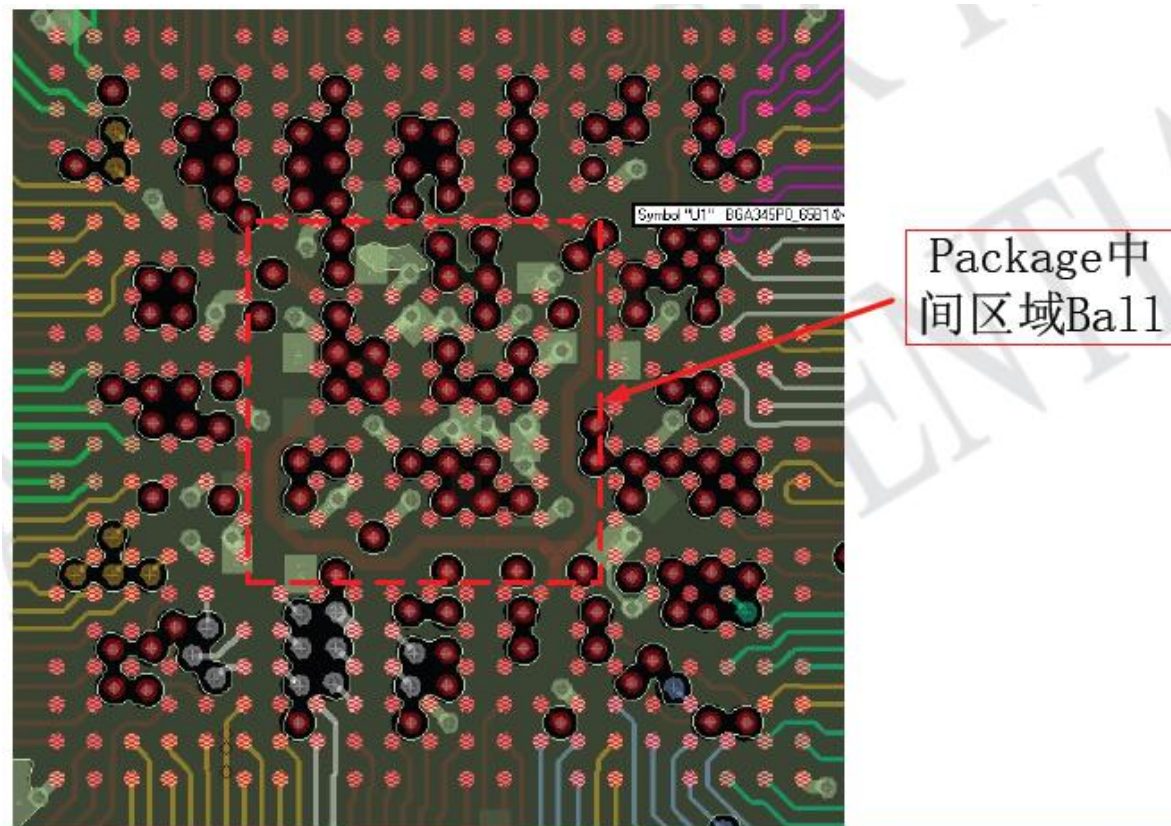
17 THERMAL

3. AP尽量放在PCB靠中间的位置，PMIC/PA等较大功率器件摆放位置离PCB边缘不能过小（不小于10mm）



17 THERMAL

4. Package中间区域的Ball是把热传导到其他平面层和底部的主要途径，需要保证与Ball连接的Via数量



17 THERMAL



5.保证GND , VDD-CPU , VDD-SYS , VDD-DRAM的每个Ball不少于一个Via。

6.在PCB Layout空间允许的情况下，在PCB背面铺保留一层完整的铜皮利于散热。

17 THERMAL

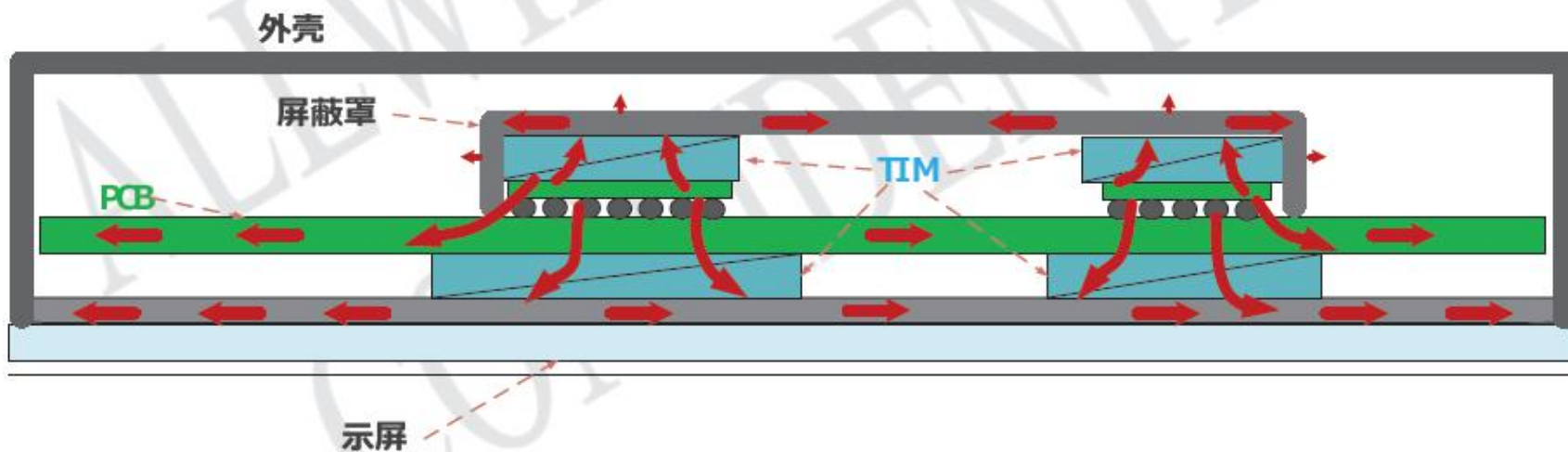
7.整机安装：显示屏在PCB背面。

PCB背面：

1. 屏上面有一层大面积金属层，可以充分利于该金属层进行导热。
2. 金属层与PCB层之间放TIM（Thermal Interface Material）材料。

PCB正面：

1. 如果AP和PMIC外围有金属屏蔽罩，可以用TIM紧贴AP和金属外壳以降低热阻。

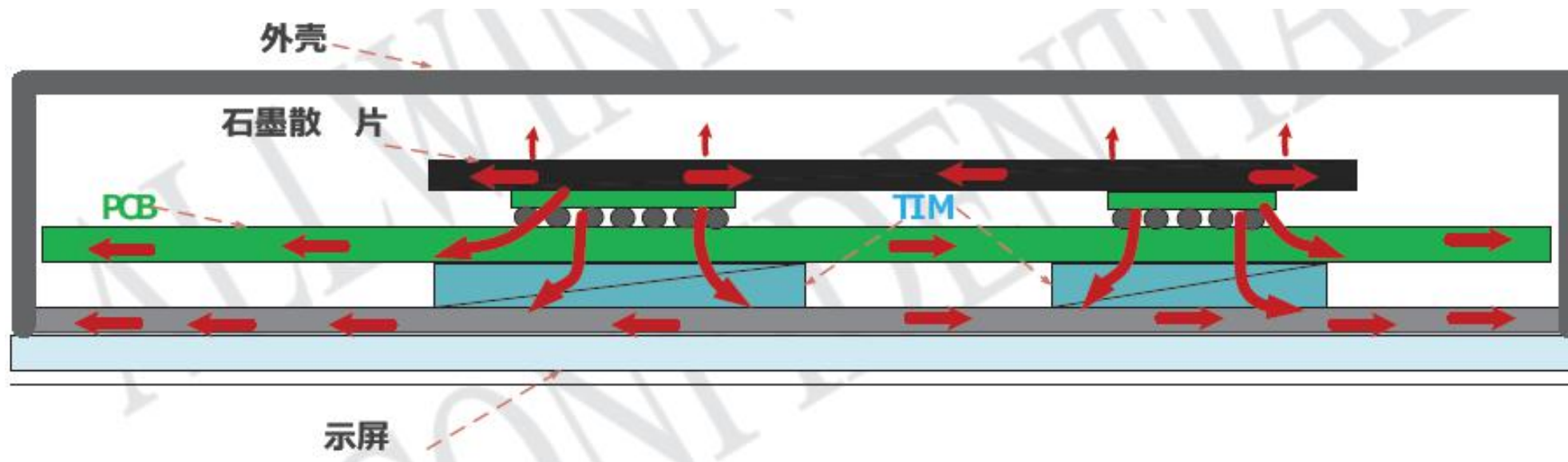


17 THERMAL

8.整机安装：显示屏在PCB背面。

PCB正面：

1. 如果AP和PMIC外围没有金属屏蔽罩，可以用石墨散热片贴在AP和PMIC上进行散热。



17 THERMAL

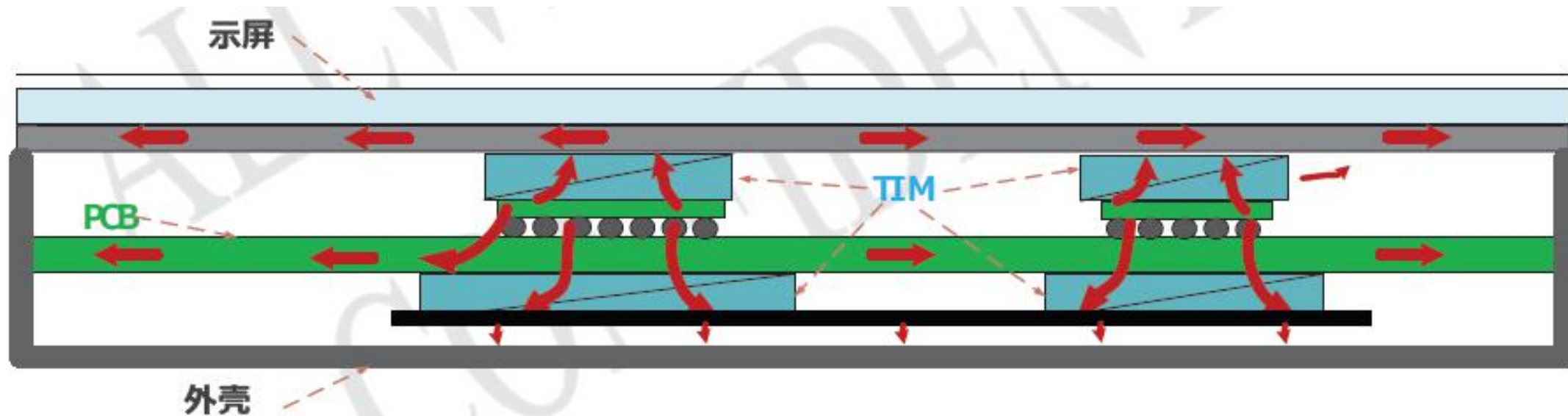
9.整机安装：显示屏在PCB正面。

PCB正面：

1. 屏上面有一层大面积金属层，可以充分利于金属层进行导热。
2. 金属层与AP之间放TIM材料。

PCB背面：

1. 在AP和PMIC的PCB背面放TIM材料，后可以在TIM上加散热片，例如0.2mm铜片和纳米材料组



18 ESD



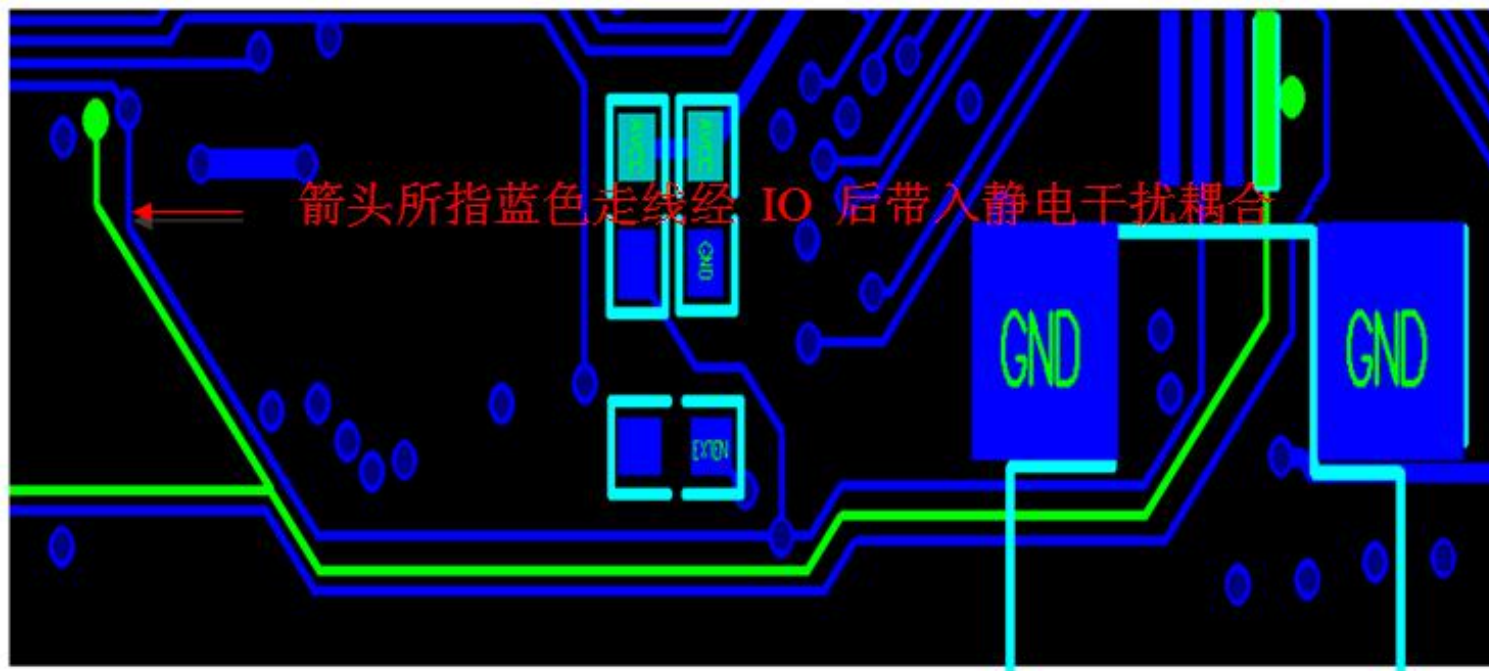
1. PCB层叠设计必须保证不少于1L完整的GND平面，所有的ESD泄放路径直接通过过孔连接到这个完整的GND平面；（完整GND平面有利于电荷的快速转移）
2. 地保护环
PCB板四周画上一条宽度不小于0.5mm(20mils)的地保护环且尽可能多铺地；
保护环铜皮不能覆盖绝缘材料（例如绿油）；
保护环需要通过过孔与GND平面相连，每10mm的距离不少于2个过孔；
保护环不能形成闭环，每隔一段距离，可以留下一个0.5~1mm的缝隙；
敏感信号不能与保护环相邻，与保护环的距离不小于0.25mm(10mils)；
与保护环相邻的非敏感信号到保护环距离不小于0.2mm(8mils)。
3. IO保护地下方尽量不要走线，在必须走线的情况下建议走内层（防止静电能量耦合到走线后造成二次污染）。

18 ESD



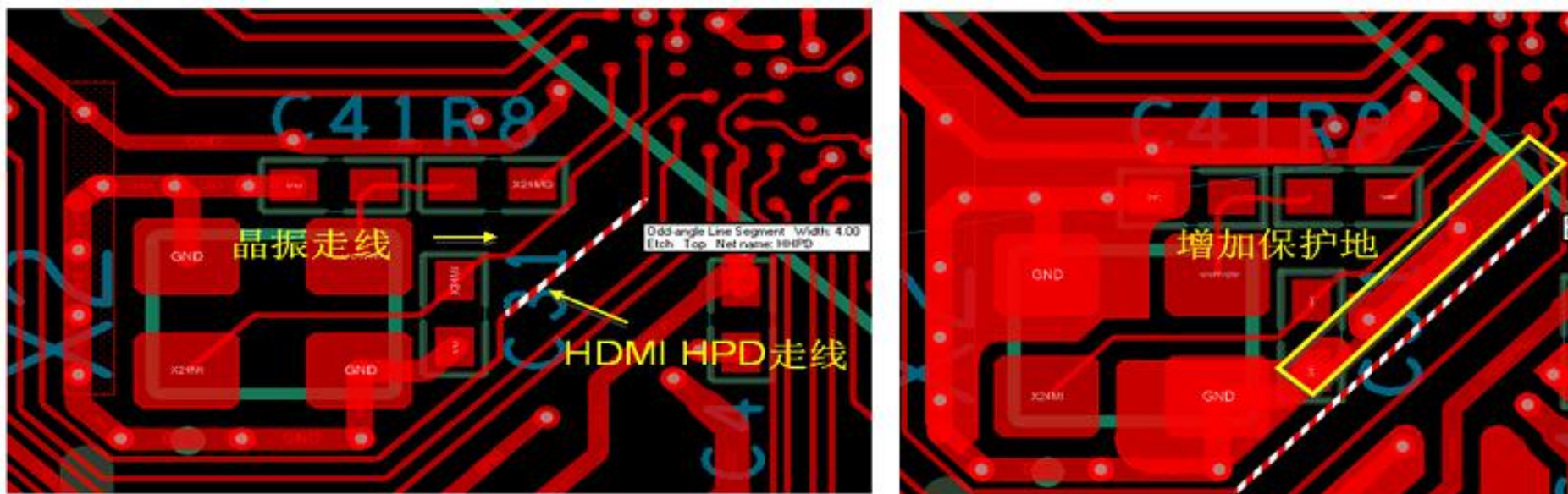
4. 关键信号（RESET/NMI/Clock等）与板边距离不小于5mm，同时必须与走线层的板边GND铜皮距离不小于10mils；（避免空气放电和GND平面电磁耦合）。
5. CPU / DRAM / 晶振等ESD敏感的关键器件，离外部金属接口的距离不小于20mm，如果小于20mm，建议预留金属屏蔽罩；并且距离其他板边不小于5mm；（避免金属连接器对内部器件放电）。
6. POWER平面要比GND平面内缩不少于3H（H指POWER平面相对GND平面的高度）。压缩第三层不必要的电源走线面积，尽可能多的铺GND。
7. 关键信号（RESET/NMI/Clock等）尽量避免与外部接口信号（USB/HDMI/SD/HP等）或经过IO附近的走线相邻并行走线；如果不可避免，相邻并行的走线长度不超过100mils；（避免外部信号的电磁耦合）。

18 ESD



禁止并行走线示例一

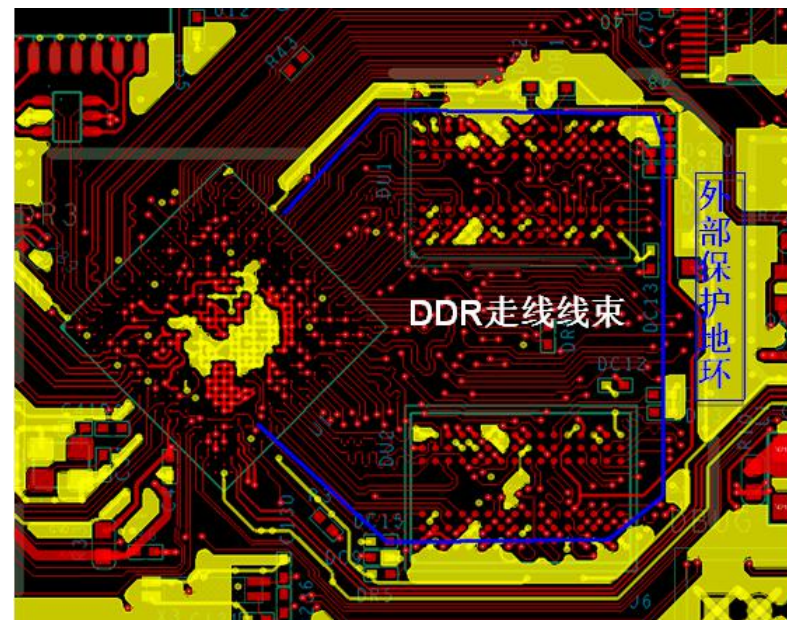
18 ESD



禁止并行走线示例二

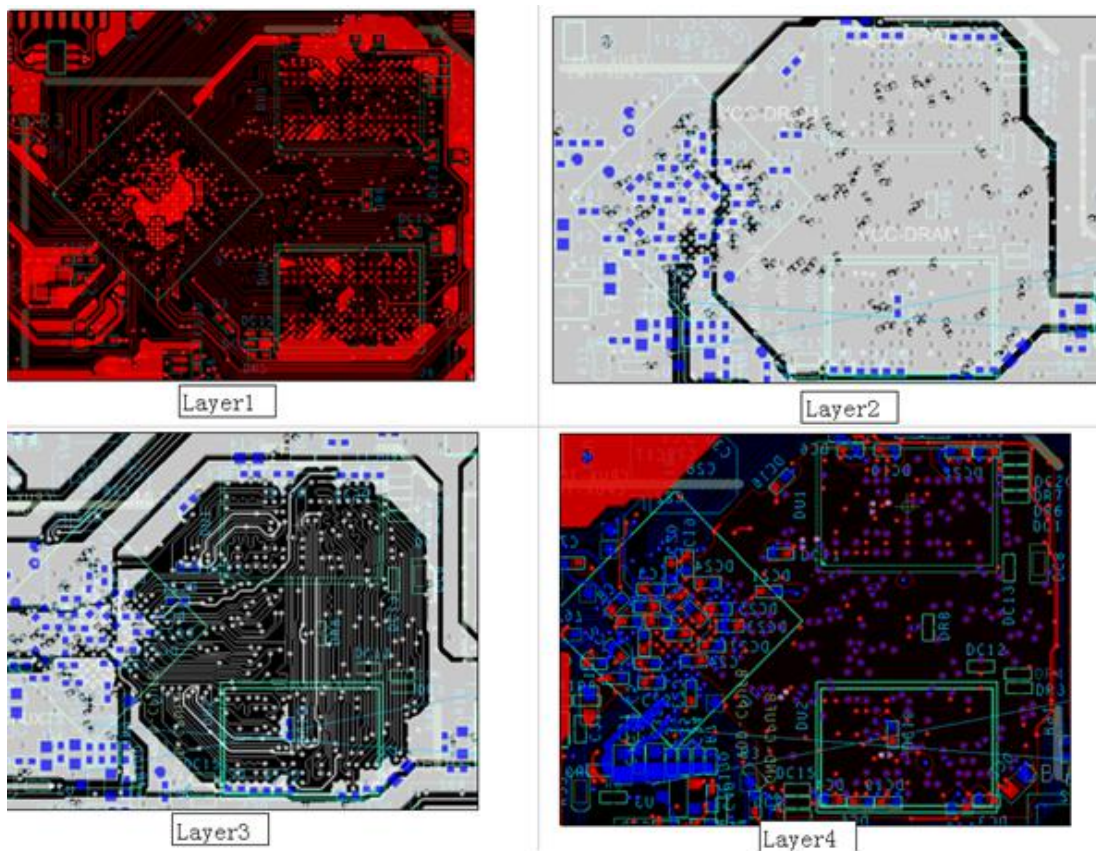
18 ESD

8. Reset信号建议增加1nF电容接地，电容靠近主控摆放；电容接地端需用过孔加强连接；Reset走线需要全程用GND走线保护；
9. 对于模组上的reset信号，需在模组上靠近芯片管脚的位置增加1~100nF电容接地。
10. 无论外部接口信号还是内部信号，走线必须避免多余的桩线（一端无电气连接的走线）；（避免天线效应，放电和接收电磁辐射）。
11. DDR线束四周建议用GND保护（屏蔽静电干扰）。



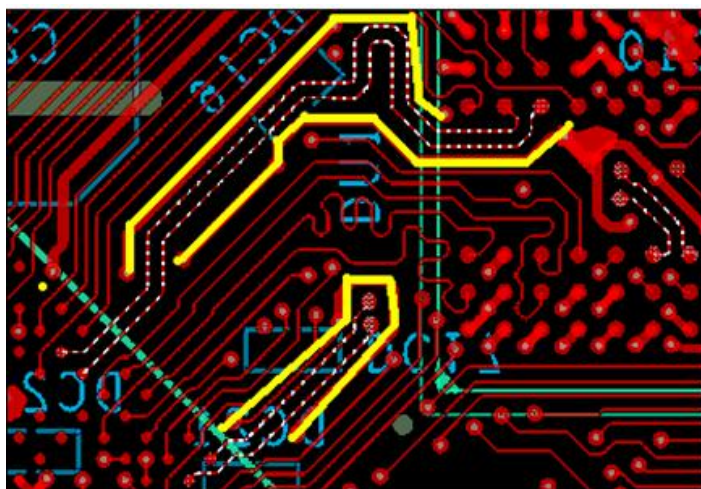
18 ESD

12.对于4层板，DDR的走线推荐采用SPSG层叠结构，即第一层走信号，第二层走电源，第三层走信号，第四层走GND（屏蔽静电干扰）。

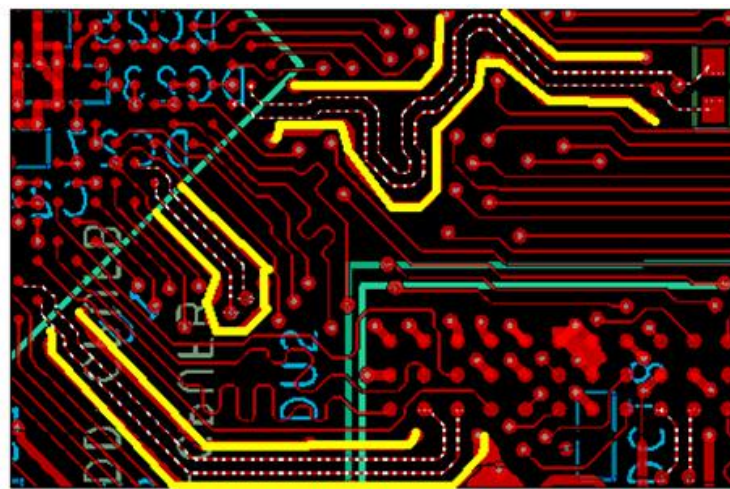


18 ESD

13. DDR Clock差分对/DQS差分对全程走线用GND走线保护，GND走线的过孔间隔要求小于等于400mil（屏蔽静电干扰）。



DQS0/1包地示例



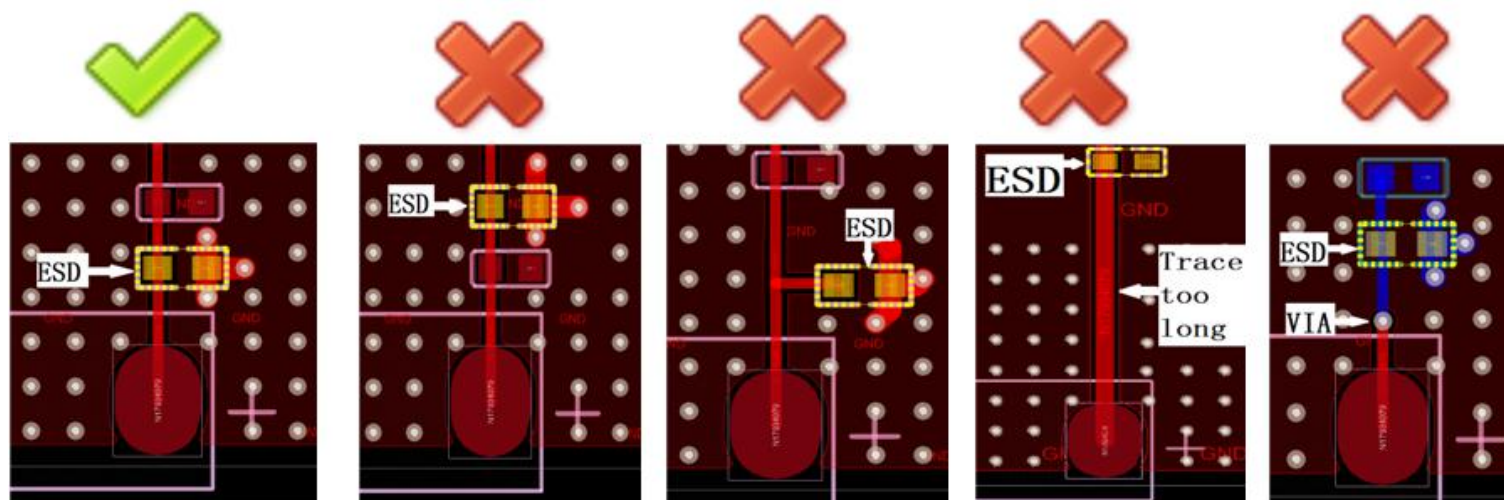
DQS2/3、CLK包地示例

14.必须保证外部连接器（USB/HDMI/SD）金属外壳接地良好，在板边直接通过过孔连接GND平面，每个GND焊盘与GND平面之间的连接过孔不少于3个。

18 ESD

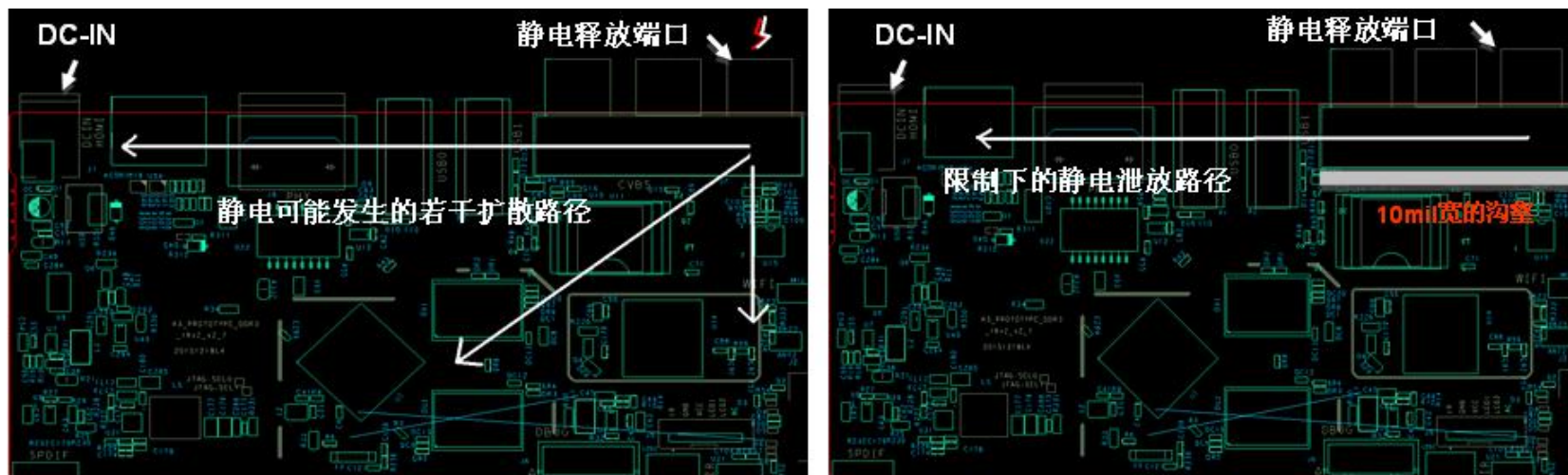
15.外部接口信号（USB/HDMI/SD/HP）必须连接外部ESD器件，进行ESD保护。

如下图所示，外部接口信号ESD器件放置位置尽可能靠近外部连接器，与连接器间避免过孔；ESD器件接地端直接通过过孔连接到GND平面，而且过孔数量不少于3个；从外部接口进来，必须最先看到ESD器件；ESD器件的信号端与外部信号端必须尽可能短，尽可能宽，建议直接搭接在信号走线上。



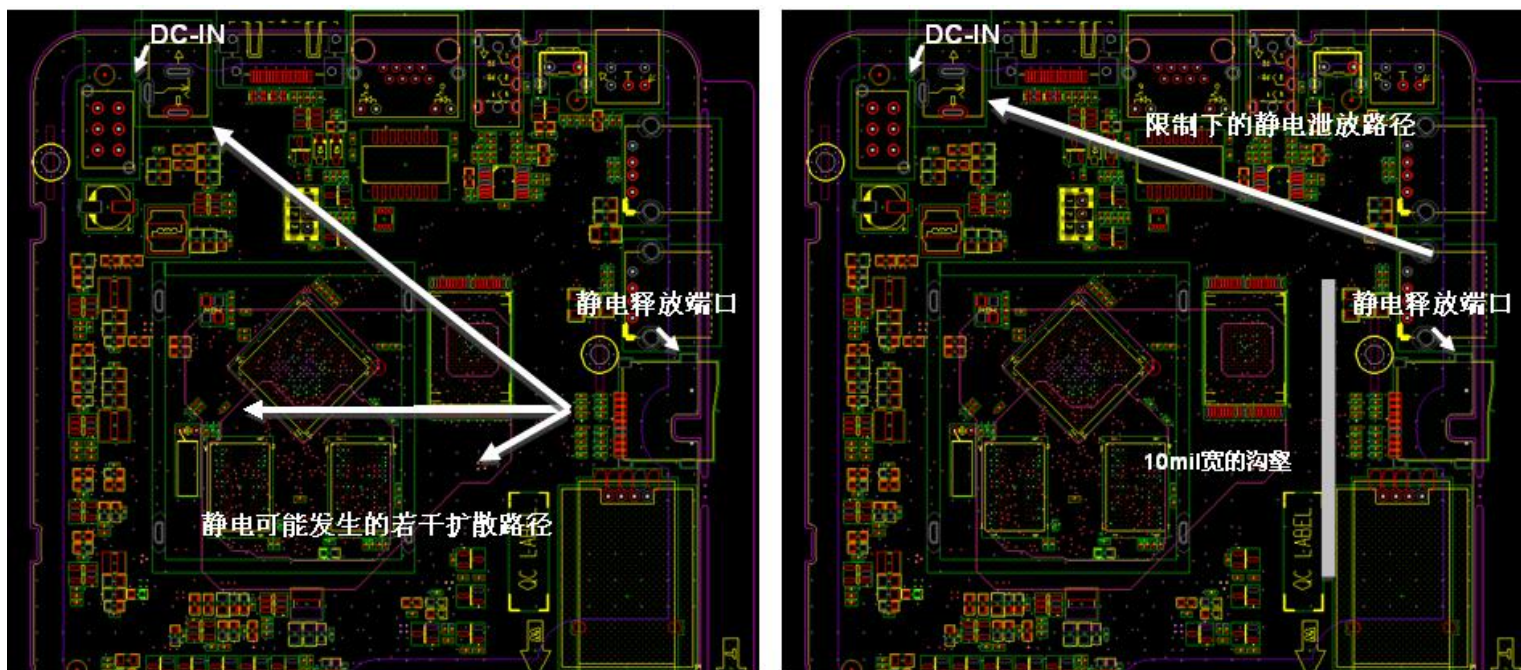
18 ESD

16.有些IO由于布局关系，远离静电泄放路径（如DC-IN端口）或者与静电泄放路径形成对角线关系（静电泄放路径经过主控下方极易造成干扰）。这类IO容易在静电测试时造成系统失效。建议于此类IO的GND附近在PCB所有层割一段10mil宽的沟壑，以引导静电按照设计路线泄放，阻止能量串入主GND。



割壕沟示例一

18 ESD



割壕沟示例二

18 ESD

17.如果系统包含了其他子板（如按键子板，天线子板），这些子板上的ESD器件建议放在主板上靠近座子的位置。



18 ESD



- 18.建议在PCB板双面四周均匀留出多个不小于25mm²的GND裸露铜皮（此铜皮直接通过过孔与GND平面相连），并通过导电棉与金属平面相连接。
- 19.如果结构允许，建议增加屏蔽罩，对关键电路进行屏蔽，同时必须保证屏蔽罩的各边良好接地；（避免屏蔽罩电荷积累，对内部信号放电）。

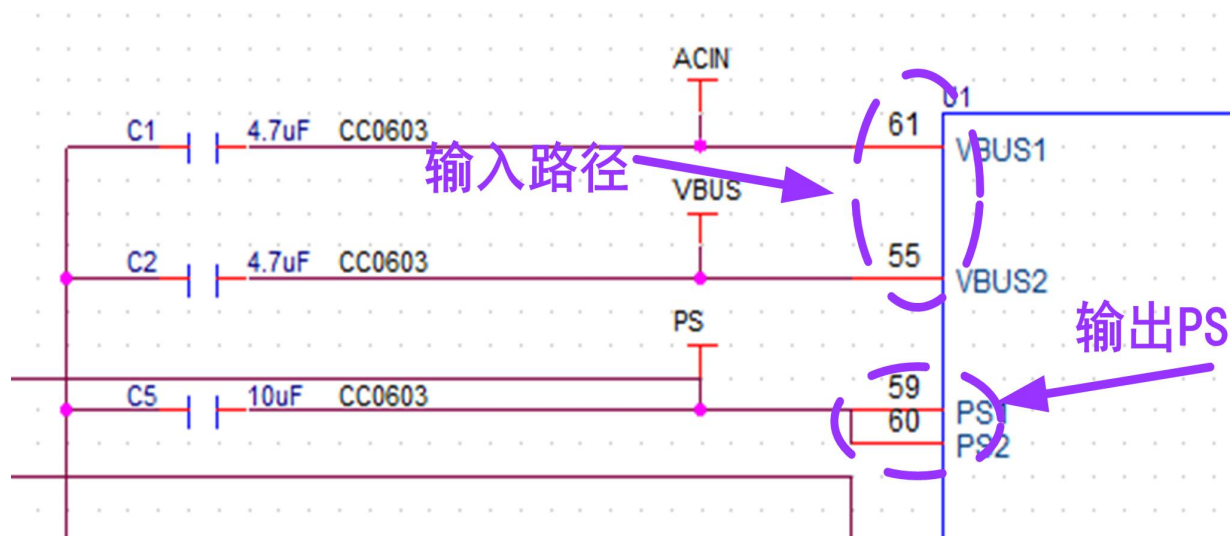
19 PMU



- 1.推荐采用4层(顶层，S1,S2,底层)，顶层或底层放置元器件，顶层和第三层走功率（电源）路径。第二层为地层，底层以信号优先，其次是难以在顶层和第三层布的功率路径。4层以上的，可以单独为信号使用一层。
2. 对于PMIC的使用面积充分的应用，PMIC及电感、电容等主要器件放在同一层，地层紧邻PMIC放置层，比如PMIC放在第一层，则地层设置在第二层；对于PMIC使用面积特别紧张的，可以把电感电容等大器件放至在PMIC对面一层的正下方。
- 3.通常用以下几种方式评估路径：
1mil的铜厚(包含沉铜厚度)，则1A电流需要预留28mil的线径宽度。
 $DCR (mohm) = \text{长度} / (\text{宽度} * OZ)$,例如长度是宽度100倍，1OZ铜厚，则DCR为1mohm，0.5OZ则是2mohm。
一个8mil的过孔通流能力为500mA。

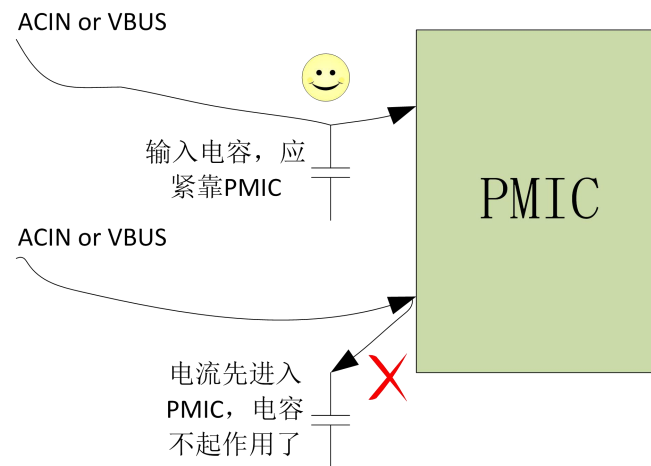
19 PMU

4. IPS在功能上是把PMIC外部的电，如充电器，电池，外部电脑等通过VBUS或者ACIN导入到PMIC中，经过智能管理，通过PS输出，PS输出的电既可以送给系统中的其它功能供电如液晶屏，保护电路等，也可以给PMIC的DCDC, LDO，辅助功能供电。这里有几点值得注意：



19 PMU

5. VBUS或者ACIN的路径尽量用铺铜，宽度尽量大，最少应保证可以流过最大的规格电流；应至少保证有84mil的宽度来流过 $I_{in_max}=3A$ 的电流。但是通常VBUS和ACIN从较远的connector端引入，要求从引入端到芯片的pin， $DCR \leq 0.04\Omega$ 。这就要求在宽敞的地方尽量铺宽VBUS和ACIN，要求长度 \leq 宽度的40倍，而不是局限于84mil宽度。
6. 输入滤波电容尽量靠近VBUS和ACIN pin，使外部来的电先通过电流滤波后再进入到PMIC。如有过孔到电源层的过孔不少于4个；



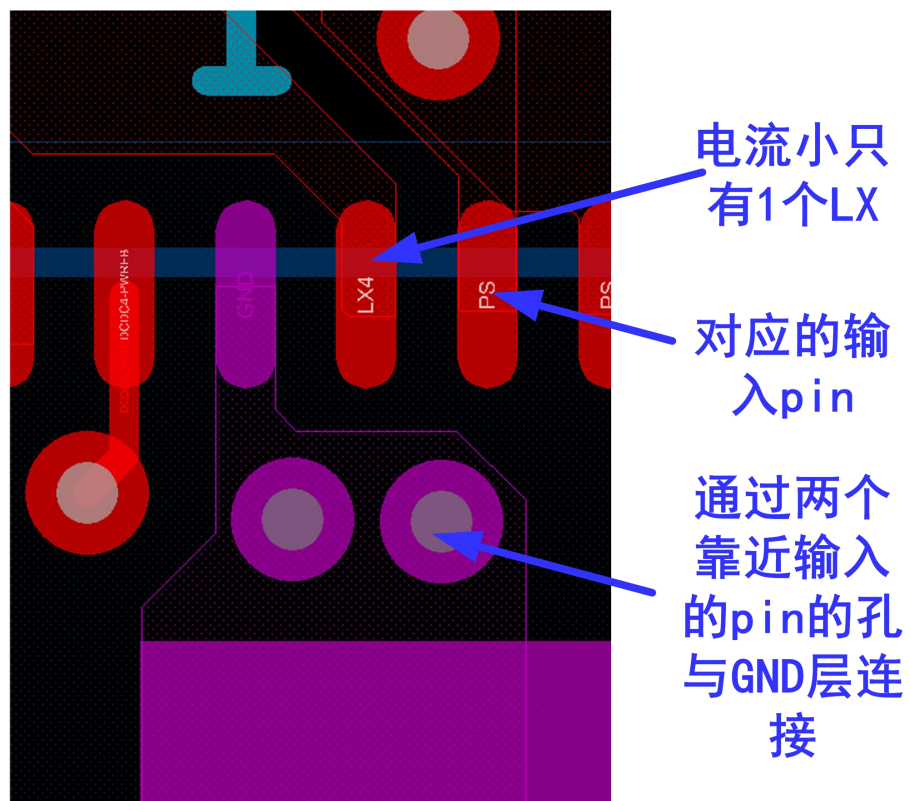
19 PMU



7. IPS模块的输出端一般为PS pin，它的滤波电容尽量靠近这个PS Pin，走线尽量宽，铺铜，到电源层的过孔不少于4个；
8. PS也为PMIC的其它模块供电，如给Charger提供输入，给DCDC，LDO提供输入，因此PS最好有一个电源平面。减小PS到DCDC，LDO的阻抗，尽量用打孔到电源平面，铺铜的方式。
9. 电感如与PMIC相接，保证电容位置的前提下，尽量靠近PMIC的LX pin。线宽保证电流需求即可，不要太宽。
10. 如果PMIC 有PGND pin, 则要注意PGND与GND层的连接。通常PMIC的PGND紧挨着DCDC，charger的LX或者VIN。

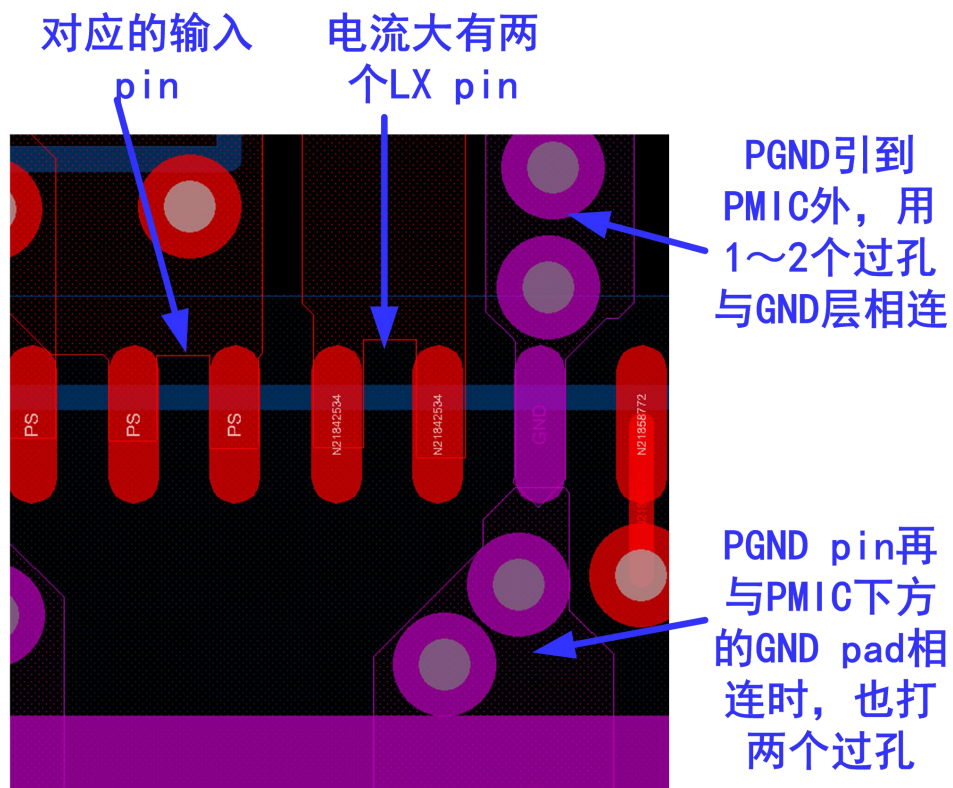
19 PMU

11.对0 ~ 1.5A的buck, DCDC, charger, boost, 通常只有1个LXpin。其PGND pin与电容的连接是通过打孔到地层。打孔的位置可以在如下图所示地方, 可以在PMIC内打孔。



19 PMU

12. 对1.5A ~ 3A的buck, DCDC, charger, boost, 通常有2个LXpin。其PGND pin与电容的连接是通过打孔到地层。打孔的位置可以在如下图所示地方。在PMIC内和外部都打孔。如果有地方PMIC外打2个孔，如果没有地方则打至少1个孔

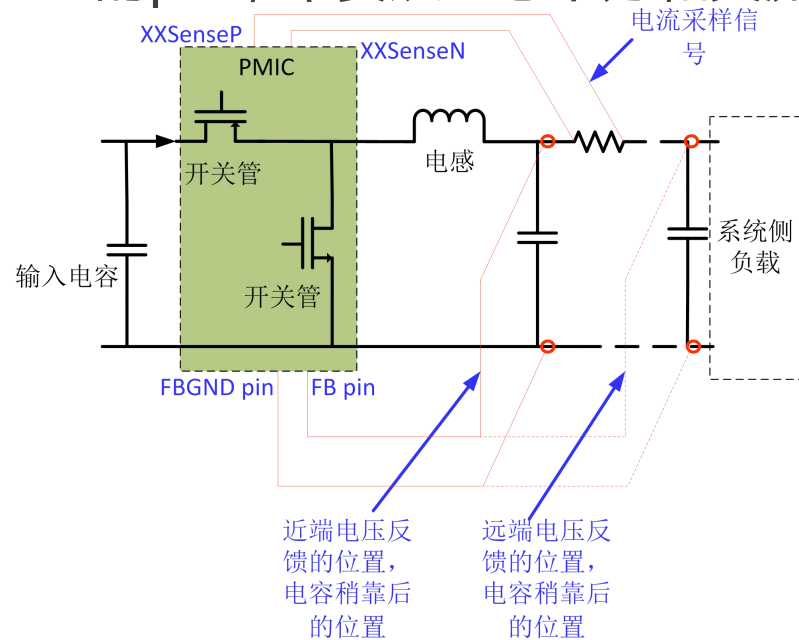


19 PMU

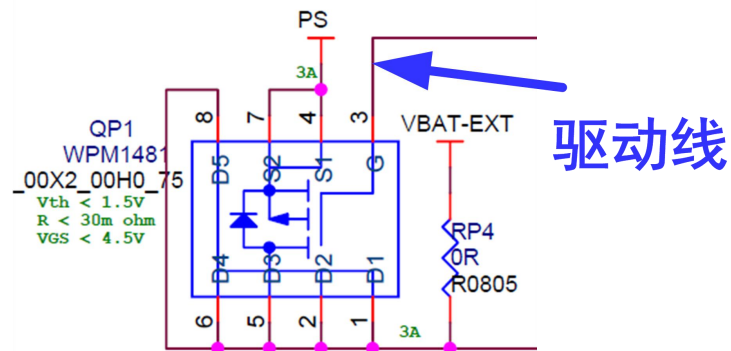
13. 对于电流 $>3A$ 的buck, DCDC, charger, boost, 通常有 >2 个LXpin。其PGND pin与电容的连接是通过打孔到地层。

14. DCDC敏感信号主要有电流反馈线, 电压反馈线, 驱动线, 和自举电路线。一般信号线

(1) 电流反馈线, 采用差分走线, 从采样电阻的一端开始到PMIC的pin, 不要从电感下方和交流路径的下方走线, 一般用4~10mil即可

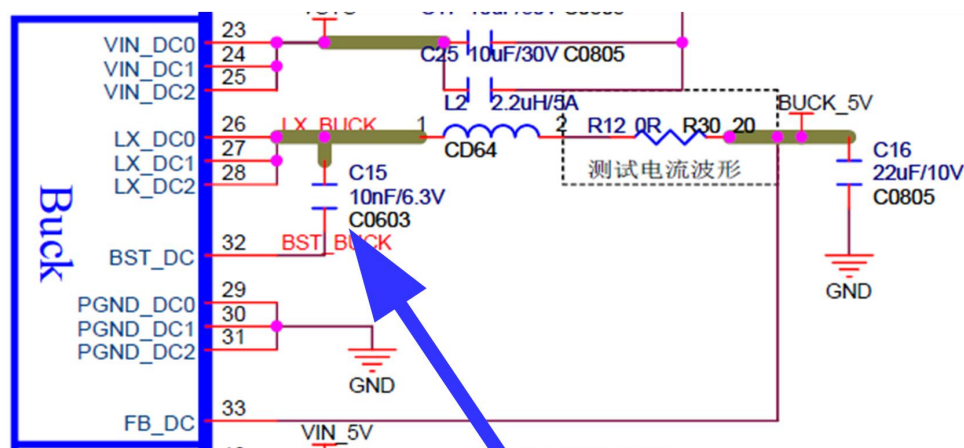


- (2) 电压反馈线，输出电压经过电容滤波后，紧挨电容取点，用4~10mil的线引入PMIC即可，最好不要从电感下方，交流路径下方，或者紧挨CLK之类的跳变信号。建议CPU，GPU，SYS，DRAM供电时，从远端反馈。如果SOC有反馈pin则连接至反馈pin，如果没有反馈pin，则连接至远端反馈电容两端。反馈线从底层信号层走线，沿其电源平面一起走到负载。
- (3) 驱动线，一般是PMIC给MOS作为驱动的信号。用4~10mil的线，从信号层引入到MOS的gate即可，gate附近打孔到信号层。要区分这个驱动信号线常态为固定电平还是跳变电平，如果是跳变的，不要让它受到其它跳变信号干扰；如果是固定的可以不像跳变信号那么严格要求。



19 PMU

(4) 自举驱动供电线路，一般用作上下管的驱动供电。电容的取点应靠近电感端的LX端；如一般以BST命名的pin外接的电容一端连接LX时，取点应靠近电感取点。用10mil即可。



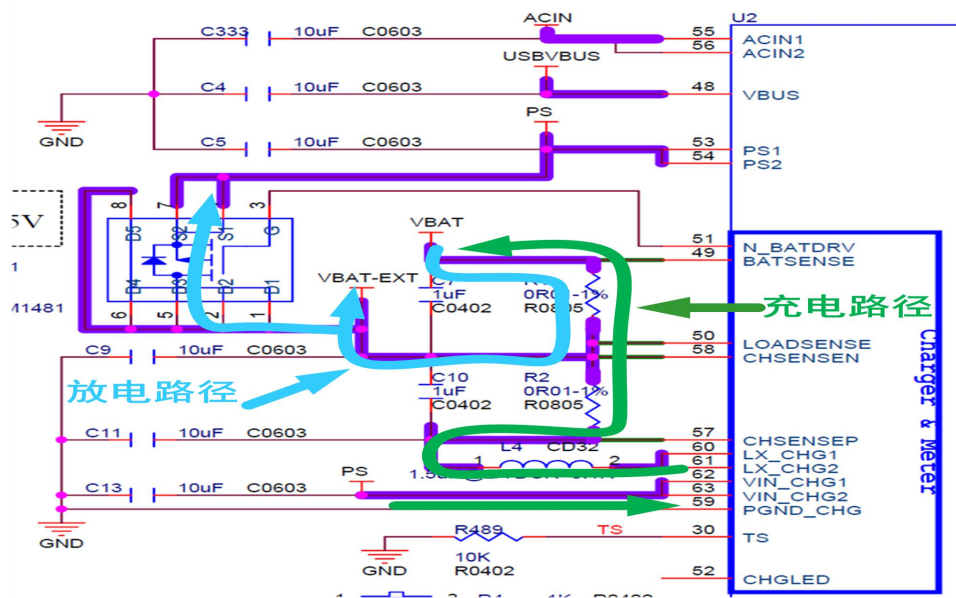
自举供电电容

19 PMU

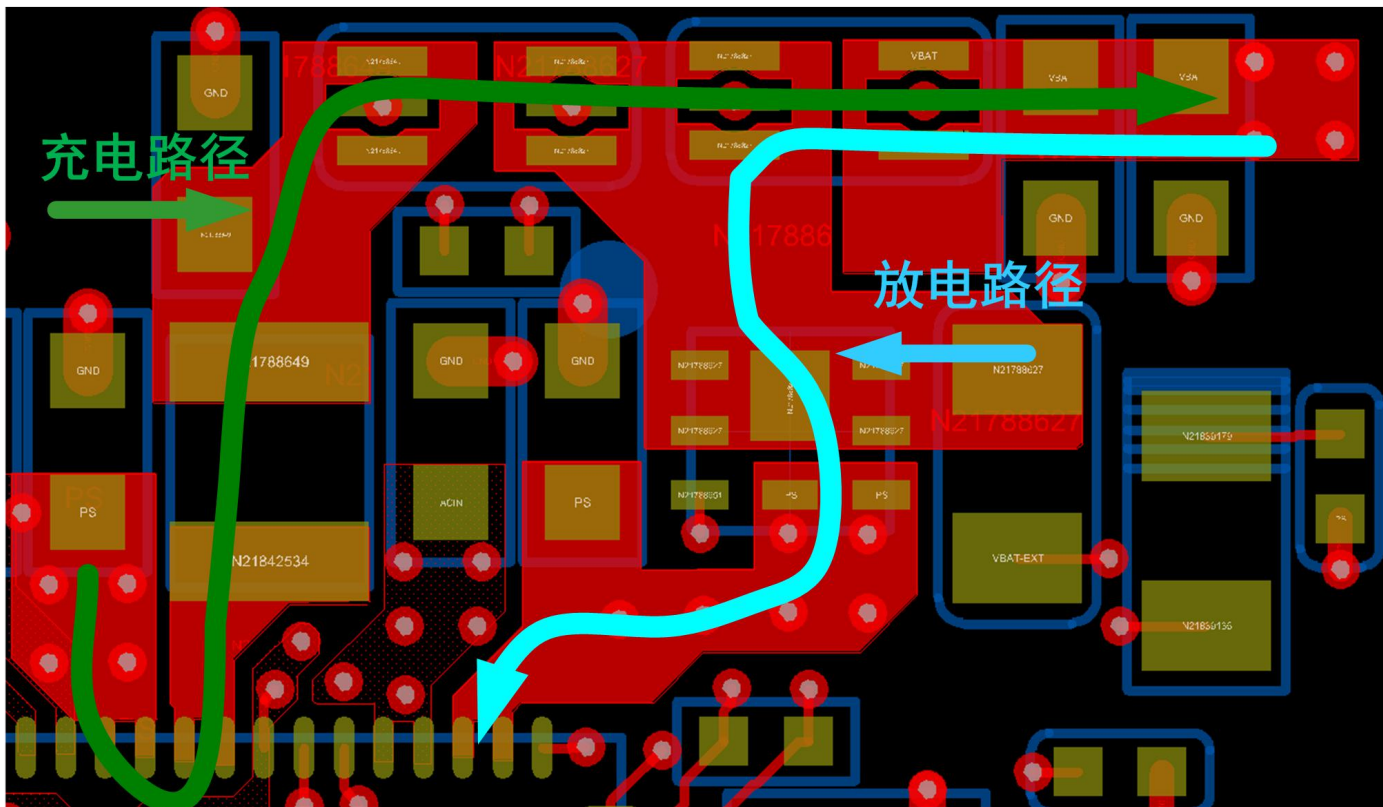
15. 充电路径为PS->VIN_CHG->LX_CHG->电感->采样电阻->BAT，尽量采用铺铜，路径短。如下图绿色箭头线。

放电路径为VBAT->采样电阻->外部PMOS->PS，尽量采用铺铜，路径短。如果有单独的放电采样电阻，原则与充电采样电路相同。如下图蓝色箭头线。

充电路径和放电路径如下图所示。

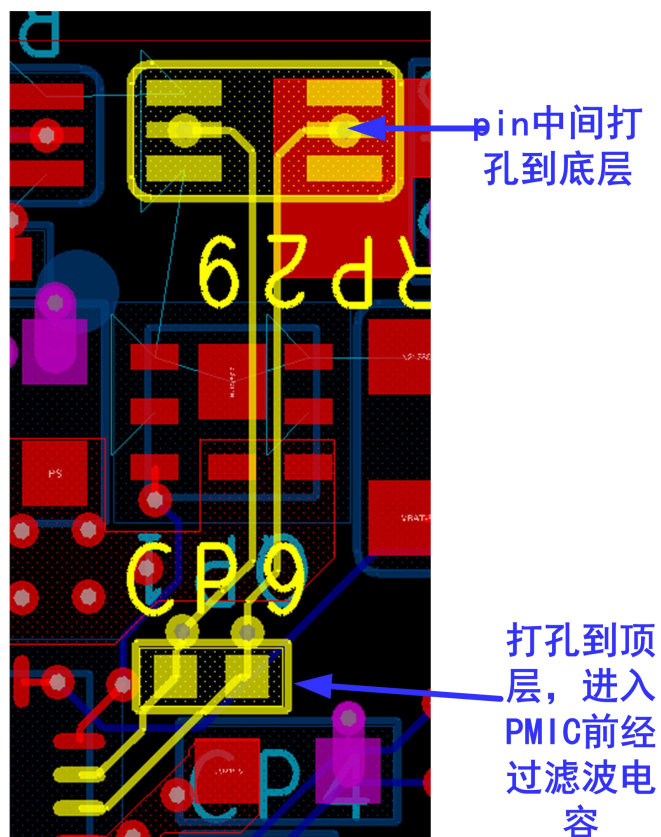


19 PMU



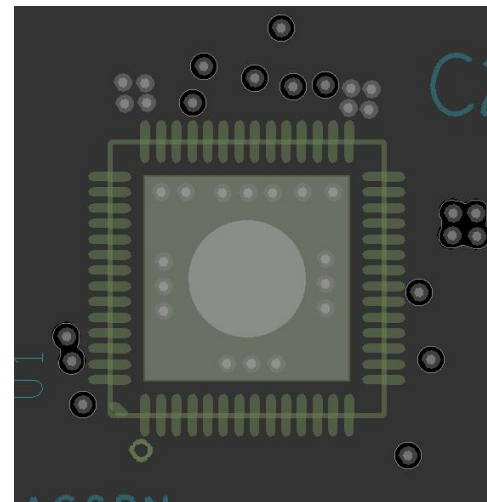
19 PMU

16. 电流采样路径用4~8mil即可，从电阻采样pin中间取点打孔到底层，差分走线到PMIC附近，如果电流采样有滤波电容，打孔到顶层进入PMIC前，先经过滤波电容。如下封装形式如下图所示：



19 PMU

- 17. 输入电容尽量靠近PMIC的LDOIN Pin，保证输入路径的宽度满足电流要求，通常100mA~1A；
- 18. 输出电容尽量靠近PMIC的LDOOUT Pin, 保证PMIC的输出经过LDO电容后再向负载供电，线径满足电流要求，通常为100mA~2A；
- 19. VREF的电容尽量靠近Pin脚，电容接地点尽量远离跳变点，避免干扰
- 20. PMIC底部PAD多打孔到地层相连，在地层用全连接方式。如下图：



19 PMU



- 21. 系统与PMIC的通讯信号，也是跳变信号，避开敏感信号，采用4mil的走线。
- 22. PMIC辅助功能信号，如Led，TS等。没有过多要求。
- 23. PMIC有一些I/O口，具有LDO功能，或者Switich功能；走线时，注意线宽，尽量采用铺铜。

20 DRAM



1. SOC支持DDR3/3L、LPDDR2、LPDDR3，使用时需先确定DRAM的类型，以及单片的位宽，参考标案原理图连接
2. 主控和DRAM端每一个ZQ PIN都必须接240R-1%精度的下拉到地电阻.
3. SDQ0-SDQ7，SDQ8-SDQ15，SDQ16-SDQ23，SDQ24-SDQ31分别为4组数据线，若用DDR3/3L，则可以进行组内或者组间交换，若进行组间交换，则相应的SDQM和SDQS差分对也必须对应交换.
4. 若用LPDDR2或者LPDDR3，则SDQ0-SDQ7，SDQM0，SDQ0，SDQS0B必须与主控一一对应连接，而其他高位的3组DQ以及高位的DQM和DQS差分对，则与DDR3类似，可视PCB走线难易程度进行组内或组间交换。

21 KEY



1. 键数选择，根据需要，直接去掉后面的按键。
2. 按键采用线控按键，KEYADC网络的采样范围为0-2V，在添加按键时保证按键按下后KEYADC网络电压范围为0-1.35V，并保证任意两个按键按下时KEYADC电压差必须 $\geq 0.15V$ 。
3. 如果不需要按键，若考虑SDK兼容，则KEYADC必须加100K上拉电阻到AVCC，否则KEYADC可以floating。

22 STACK UP

1. 四层板，叠层结构和阻抗控制建议如下（如果需调整板厚，请调整2、3层之间介质厚度，保持其他介质厚度不变）

Total layers:	4							
Board thickness:	1.6 mm +/- 10%							
PCB material:	Typical FR4							
Surface finish:	ENIG(化学镀金)							
Stackup Control Table								
---	Stackup Structure				Impedance Requirements			
Layer	Type	Thickness (mil)		Dk(with Sim Z0)	Impedance spec (Ohms)	Reference layer	Width/space (mil)	Sim Z0(Ohms)
	solder mask	0.5	SM	4.25				
1	TOP	1.6	0.3oz+plating		50±10%	2	4	52.18
					90±10%	2	4.5/7.5	90.03
					100±10%	2	3.8/8.7	98.5
2	prepreg	2.9		4				
	GND	1.2	1.0oz					
	core	50.0		4.5				
3	VCC	1.2	1.0oz					
	prepreg	2.9		4				
4	BOTTOM	1.6	0.3oz+plating		50±10%	3	4	52.18
					90±10%	3	4.5/7.5	90.03
					100±10%	3	3.8/8.7	98.5
	solder mask	0.5	SM	4.25				
	Board thickness:	62.4						

22 STACK UP

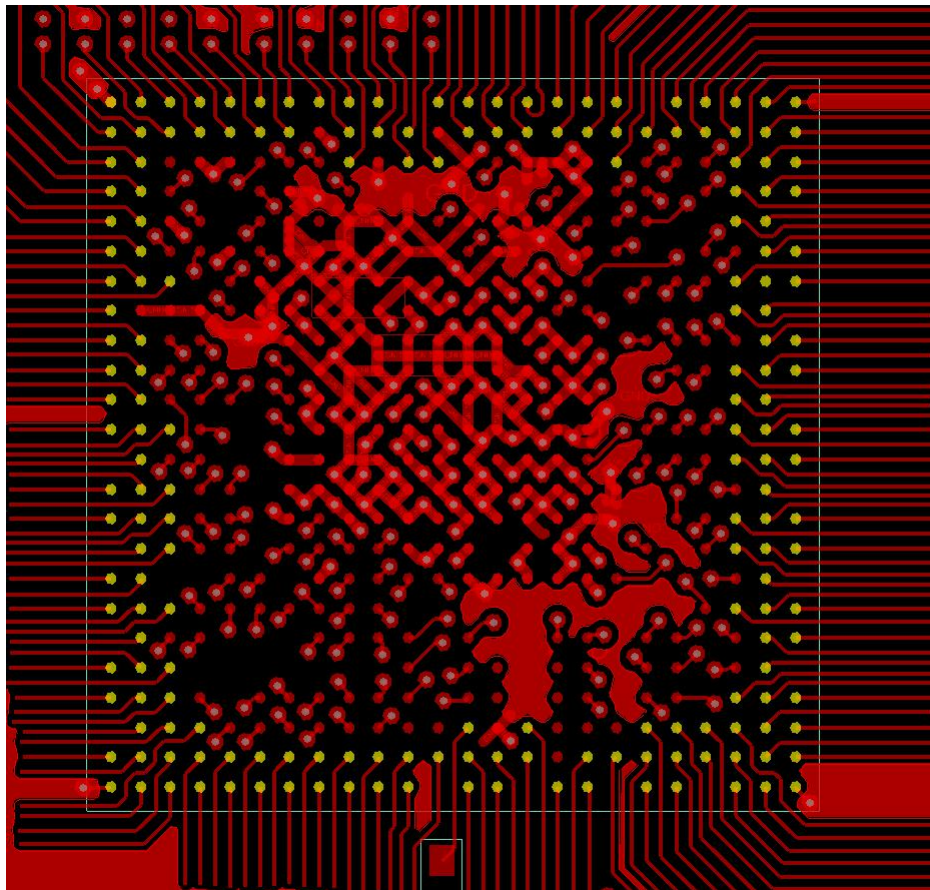
2. 六层板，叠层结构和阻抗控制建议如下（如果需调整板厚，请调整3、4层之间介质厚度，保持其他介质厚度不变）

Total layers:	6
Board thickness:	1.6 mm +/- 10%
PCB material:	Typical FR4
Surface finish:	ENIG(化学镍金)

Stackup Control Table								
---	Stackup Structure				Impedance Requirements			
Layer	Type	Thickness (mil)		Dk(with Sim Z0)	Impedance spec (Ohms)	Reference layer	Width/space (mil)	Sim Z0(Ohms)
	soldermask	0.5	SM	4.25				
1	TOP	1.6	0.3oz+plating		50±10%	2	4	52.18
					90±10%	2	4.5/7.5	90.03
					100±10%	2	3.8/8.7	98.5
	prepreg	2.9		4				
2	GND1	1.2	1.0oz					
	core	4.0		4.2				
3	SIG	1.2	1.0oz		50±10%	2&4	4	51.67
					90±10%	2&4	4.5/7.5	88.18
					100±10%	2&4	3.8/8.7	96.3
	prepreg	40.0		4.5				
4	GND2	1.2	1.0oz					
	core	4.0		4.2				
5	VCC	1.2	1.0oz					
	prepreg	2.9		4				
6	BOTTOM	1.6	0.3oz+plating		50±10%	5	4	52.18
					90±10%	5	4.5/7.5	90.03
					100±10%	5	3.8/8.7	98.5
	soldermask	0.5	SM	4.25				
	Board thickness:	62.8						

23 SOC FANOUT

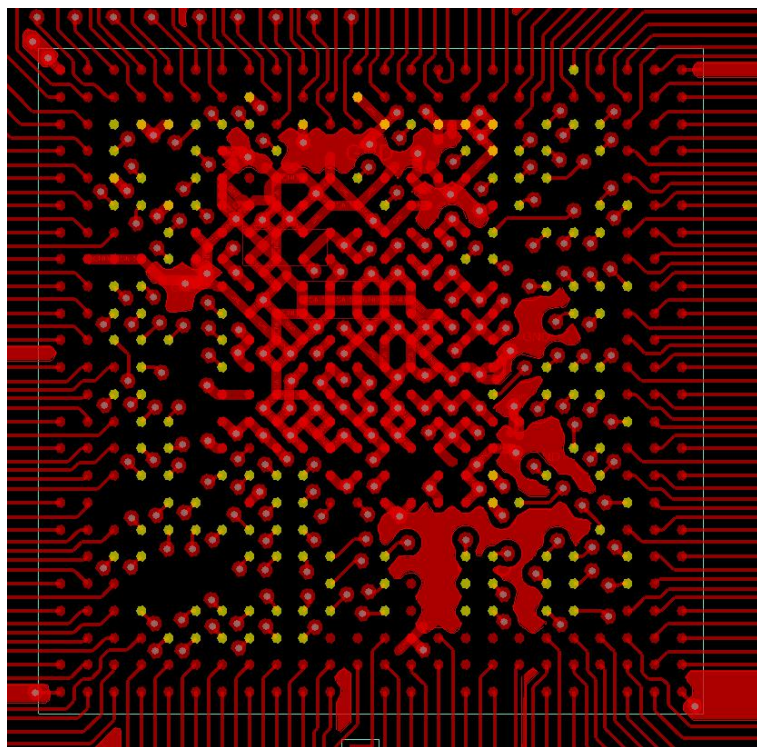
1. 第一圈、第二圈、第三圈部分Ball，可以从顶层直接拉出走线（线宽4 mil，线距4 mil）



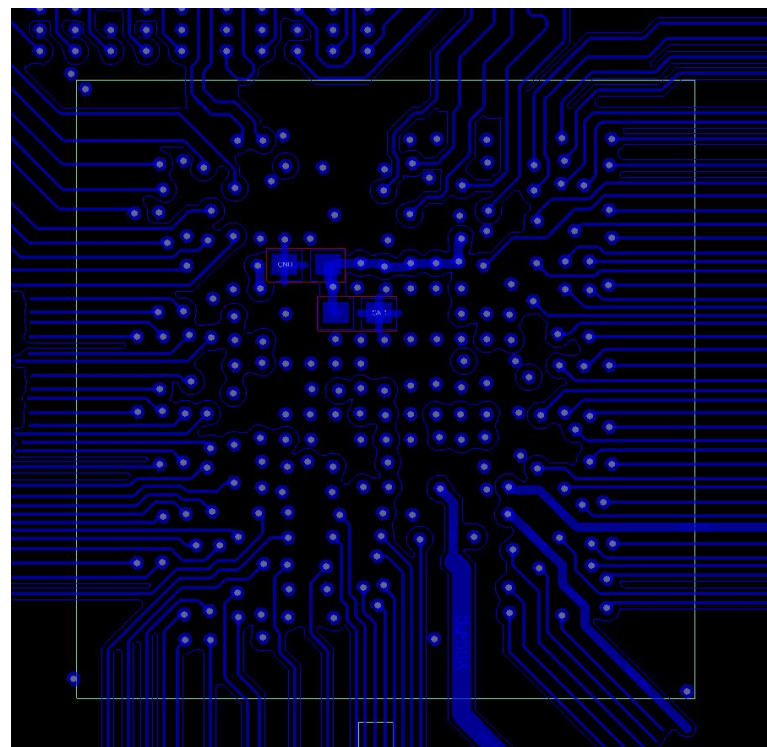
23 SOC FANOUT

2. 第四到五圈的Ball，用8/16mil过孔扇出，从Bottom层出线（6层板也可从内层信号层出线）

TOP层

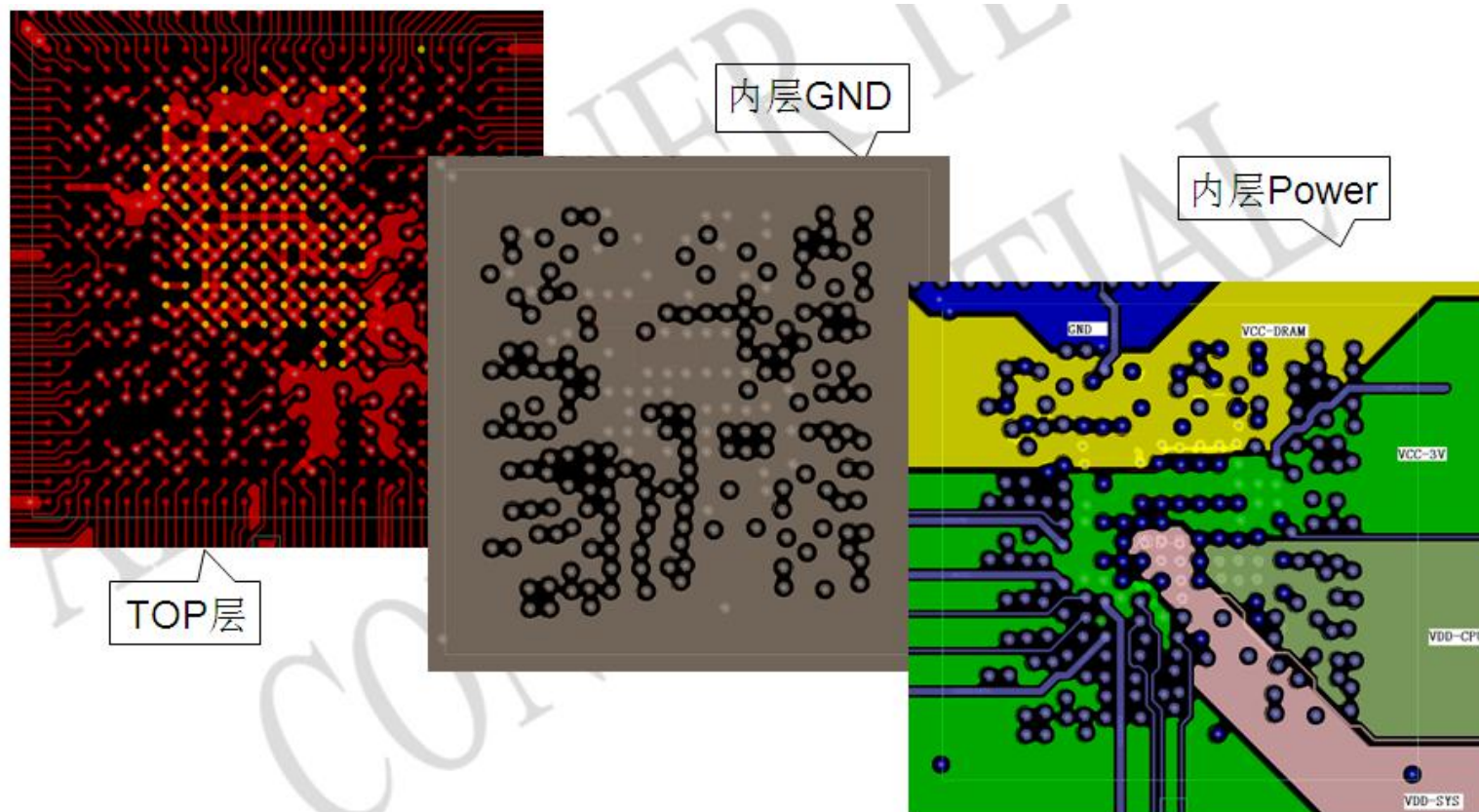


BOTTOM层



23 SOC FANOUT

3. 中间Power和GND的球，用8/16mil过孔从内层覆铜出线，注意留出尽量多的覆铜通道：



24 REVISION HISTORY



V0.1	20180626	初稿
------	----------	----

THANKS